

من تحضير وإعداد

الاستاذ المهنـدس: لـواـسـف بـوـفـاتـح

ثانـويـة رـاجـ بـرـكـاتـى

الـجـنـوبـى

بلـدىـهـ اـفـلـو

ولـاـيـةـ الـأـغـواـط

EMAIL : LOUASSEF@msn.com

التدريـسـ بالـمـشـارـيعـ

مشروع المرحل السكـونـى

المحتوى:

الوضعـيةـ الإـشـكـالـيـةـ

الوضعـيةـ التـعـلـيمـيـةـ

المرحل السـكـونـىـ (ـالـمـفـاتـحـ التـراـنـزـسـتـورـىـ)

التـراـنـزـسـتـورـ تـنـائـيـ القـطـبـيـةـ

تـراـنـزـسـتـورـ تـأـثـيرـ المـجـالـ

الـإـلـكـتـرـوـنـيـاتـ الضـوـئـيـةـ

الأـثـرـ الـكـهـرـبـائـيـ لـلـضـوءـ فـيـ أـشـبـاهـ الـمـوـصـلـاتـ

الـثـنـائـيـ الضـوـئـيـ

تنـائـيـ انـبـعـاتـ الضـوءـ

الـمـقاـوـمـةـ الضـوـئـيـةـ

الـتـراـنـزـسـتـورـاتـ الضـوـئـيـةـ

تطـبـيقـاتـ عـلـىـ إـلـكـتـرـوـنـيـاتـ الضـوـئـيـةـ

الـمـلـتـقـطـاتـ الـكـهـرـبـائـيـةـ

الـمـلـتـقـطـاتـ الـحـثـيـةـ

الـمـلـتـقـطـاتـ السـعـوـيـةـ

الـمـلـتـقـطـاتـ الضـوـئـيـةـ

الـمـلـتـقـطـاتـ الـمـسـتـوـىـ

الـمـلـتـقـطـاتـ الـحـرـارـيـةـ

الـكـواـشـفـ الـحـرـارـيـةـ TDR

الـشـيرـمـسـتـورـ CTP و CTN

الـوـضـعـيةـ الإـدـمـاجـيـةـ

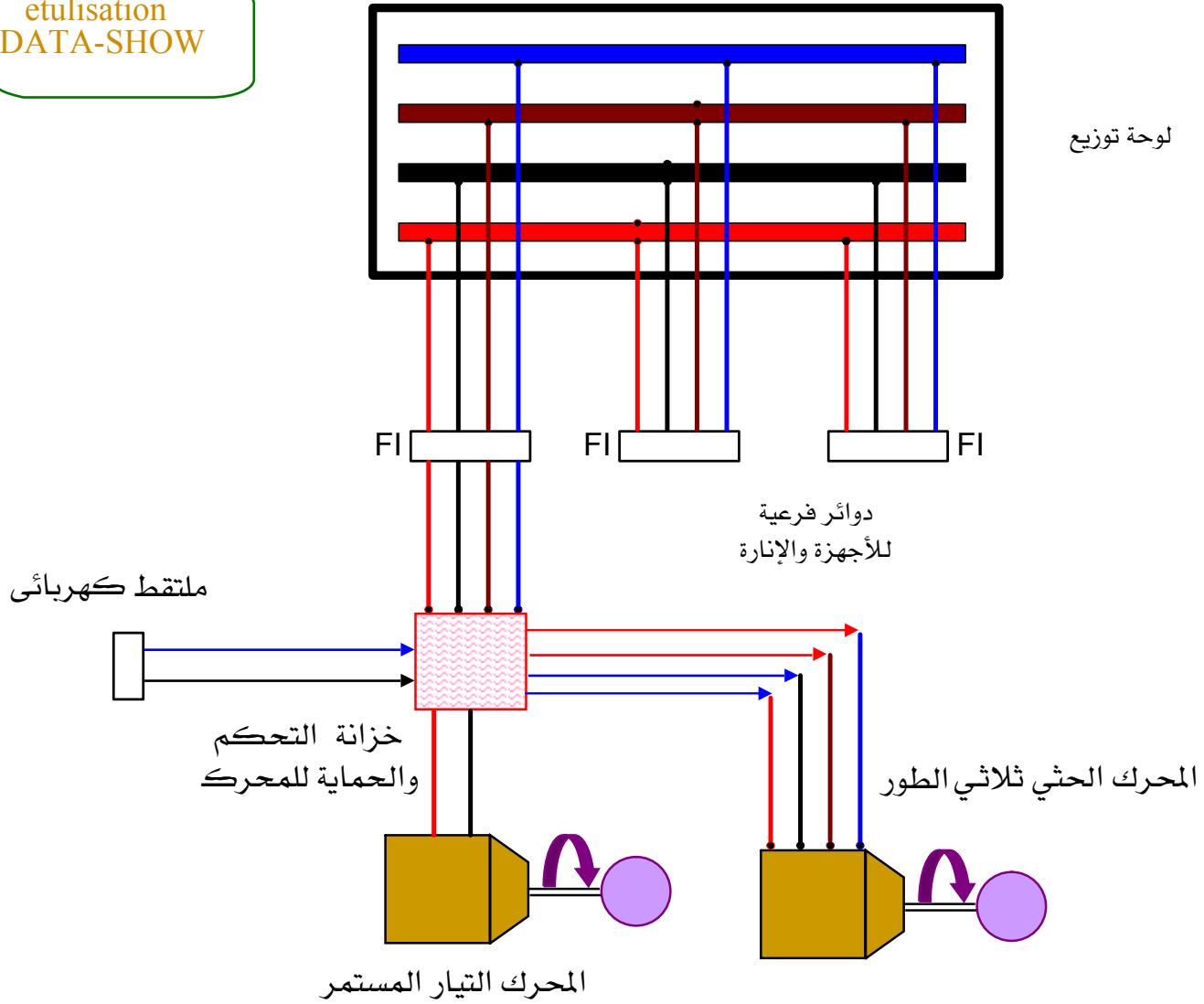
الـتـحـكـمـ فـيـ الـمـحـركـ تـلـاثـيـ الـأـطـوارـ وـ مـحـركـ الـتـيـارـ الـمـسـتـمـرـ

باـسـتـعـمالـ الـمـرـحلـ السـكـونـىـ

المهارات المنشورة:

- ❖ معرفة مبدأ عمل ترانزستور تأثير المجال ودراسة أهم أنواعها .
- ❖ معرفة المرحل السكوني بإستعمال الترانزستور ثنائية القطبية وتأثير المجال
- ❖ أهمية المرحل السكوني في التحكم الداخلي للأنظمة الآلية
- ❖ معرفة أنواع العناصر الضوئية مثل ، المقاومة الضوئية ، الترانزستور الضوئي
- ❖ معرفة الملقطات الحرارية مثل حساسات قياس درجة الحرارة بواسطة الأزدواج الحراري
- ❖ معرفة الملقطات الضوئية
- ❖ التعرف على ملقطات قياس مستوى الماء
- ❖ معرفة مبدأ عمل الإلكترونيات الضوئية .
- ❖ معرفة أشباه الموصلات مثل PTC ، NTC .
- ❖ أن يحدد الطالب أثر تغير شدة الإضاءة الساقطة على المقاومة الضوئية .
- ❖ أن يبني الطالب دارة تحكم باستخدام المقاومة الضوئية .
- ❖ أن يحدد الطالب أثر تغير شدة الإضاءة الساقطة على الترانزستور الضوئي .
- ❖ أن يبني الطالب دارة تحكم في تشغيل مرحل باستخدام ترانزستور ضوئي .
- ❖ أن يبني الطالب دارة تحكم في تشغيل الأحمال الكهربائية بواسطة الحرارة .

الوضعية الإشكالية

etulisation
DATA-SHOW

نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل وزيادة التعقيد في العمليات الصناعية المختلفة ظهرت الحاجة الماسة إلى تطور مماثل لأساليب التحكم في العمليات الصناعية ووسائل تنفيذها. ومن أهم الأساليب الحديثة التحكم الآلي في العمليات الصناعية الذي يحتل مكانة متميزة في التطبيقات الصناعية وذلك لما يتميز به في الأداء والسيطرة على أكثر من عملية في نفس الوقت، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وجودة المنتجات ومن الوسائل المهمة لتنفيذ عمليات التحكم الآلي في التطبيقات الصناعية المختلفة استخدام المقططات الكهربائية بمختلف أنواعها لاستشعار الكميات الفيزيائية كالحرارة، والضغط، والسرعة، والحركة، والقوة، والضوء، والصوت ومن ثم تحويلها إلى كميات كهربائية مكافئة لتلك الكميات الفيزيائية.

المراحل السكونية بمختلف أنواعها لربط دارات القدرة ذات التوترات العالية بالدارات الإلكترونية ذات التوترات المنخفضة،

الإشكالية:

كيف تم عملية التحكم في الإستطاعة بطريقة آلية بإستخدام المرحل السكوني والمقططات الكهربائية ما هي هذه المراحل السكونية والمقططات الكهربائية

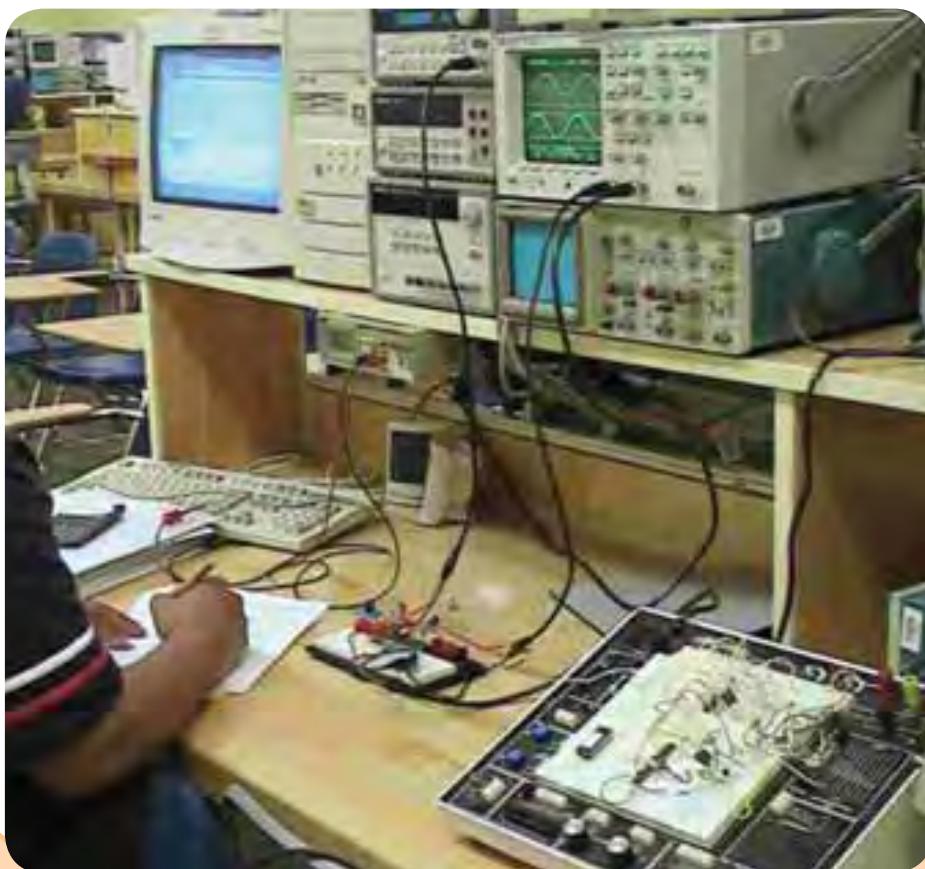
المرحلة السكونى

1
الوحدة

المفتاح الترانزستوري

من تحضير وإعداد
الاستاذ المهندس: لواصف بوفاتح
ثانوية رابح برకاتى
الحى الجنوبي
بلدية افلو
ولاية الأغواط

EMAIL : LOUASSEF@msn.com



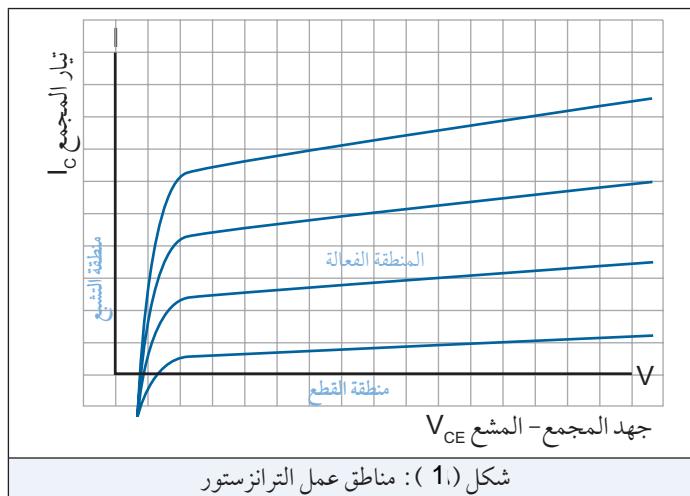
المفتاح الترانزستوري

الترانزستور ثنائى القطبية

وحدة تعليمية

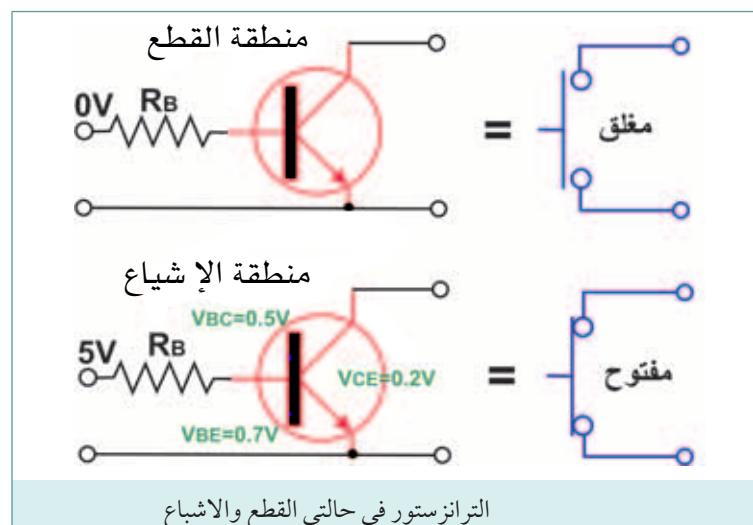
الوحدة

-1



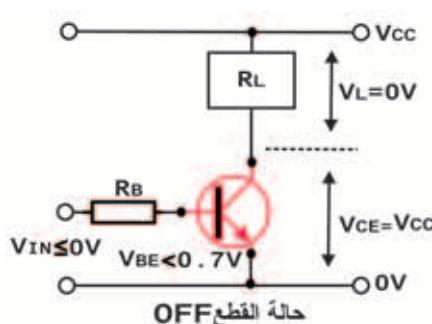
لقد تم التعرف من خلال منحني الخواص للترانزستور على مناطق التشغيل للترانزستور الثلاثة وهي القطع والفعالة والتشبع . كما هو موضح في الشكل (١) وتبين أن الترانزستور يعمل مضميناً في المنطقة الفعالة . عندما يعمل الترانزستور في منطقتي القطع والتشبع فإنه يتصرف كمفتاح يؤدي إلى وصل دارات الأحمال وفصلها

إن الترانزستور في منطقة القطع يعادل مفتاح ميكانيكي في حالة القطع (OFF) بينما الترانزستور في حالة التشبع يعادل مفتاح ميكانيكي في حالة التوصيل (ON)



٢- دارة المفتاح الترانزستوري:

أ)- حالة القطع (OFF):



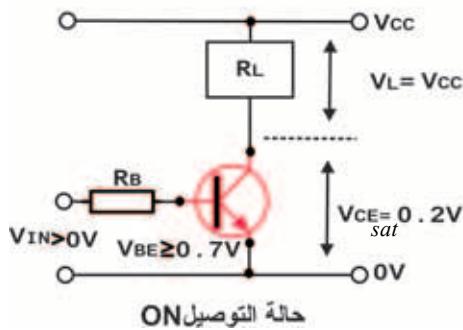
عندما تكون قيمة جهد الدخل (V_{in}) صفرًا أو صغيرة إلى الحد الذي لا يسمح بمرور تيار القاعدة للترانزستور (I_B) ٠ (٠) يكون الترانزستور في حالة القطع ويكون جهد مجمعة مساوياً لجهد المصدر (V_{CC}) ، وبالتالي تكون قيمة فرق الجهد بين طرفي الحمل مساوية لصفر مما يؤدي إلى إطفائه إذا كان مصباحاً أو توقيه عن الدوران إذا كان محركاً .

– مما سبق دراسته نجد أن الترانزستور يصل إلى منطقة القطع عندما تكون وصلة القاعدة – الباخت في حالة عدم انحياز أمامي، وبإهمال تيار التسرب فإن جميع التيارات تساوي الصفر والجهد V_{CE} يساوي جهد المصدر V_{CC} .

$$V_{CE(cutoff)} = V_{CC}$$

ب) حالة التوصيل (ON):

عند تطبيق جهد الدخل V_{in} يسري تيار في دارة القاعدة للترانزستور ، وعندما تكون قيمة هذا التيار متساوية أو أكبر من قيمة تيار القاعدة التشعبي للترانزستور، يتحول الترانزستور من حالة القطع إلى حالة التشبع وينخفض جهد مجمع الترانزستور إلى قيمة صغيرة جداً (0.2 فولت تقريباً). ويصبح جهد المصدر (V_{CC}) مطبق بكامله على الحمل ، ويسري تيار المجمع (I_c) الكبير نسبياً عبر الحمل فيضيء إذا كان مصباحاً أو يدور إذا كان محركاً. يمكن تحليل هذه الدارة وكتابة المعادلات التي تحكم عملها في حالة التوصيل على النحو الآتي :



بالنسبة لدارة المجمع الباخت:

$$V_{CC} = I_{C_{sat}} \times R_L + V_{CE_{sat}}$$

$$V_{CC} = I_{C_{sat}} \times R_L + 0.2$$

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC} - 0.2}{R_L}$$

حيث أن:

V_{CC} : جهد مصدر التغذية.

R_L : مقاومة الحمل بالأوم.

$I_{C_{sat}}$: تيار المجمع التشعبي.

بالنسبة لدارة القاعدة الباخت:

$$V_{in} = I_{B_{sat}} \times R_B + V_{BE}$$

$$V_{in} = I_{B_{sat}} \times R_B + 0.7$$

$$I_{B_{sat}} = \frac{V_{in} - 0.7}{R_B}$$

$$R_B = \frac{V_{in} - 0.7}{I_{B_{sat}}}$$

وتعطى العلاقة بين تيار المجمع التشعبي و تيار القاعدة التشعبي بالمعادلة :

$$\beta = \frac{I_{C_{sat}}}{I_{B_{sat}}}$$

حيث: β كسب التيار للترانزستور في حالة التشبع ، وتكون قيمته أقل بكثير من قيمة كسب التيار في منطقة التشغيل الخطية ، وعادة تكون قيمة كسب التيار الصغرى المعطى في لوحة بيانات الترانزستور.

شروط التشبع Conditions in Saturation

- من دراستنا السابقة نجد أن الترانزستور يصل إلى منطقة التشبع إذا كانت وصلة القاعدة - الباعث في حالة انحياز أمامي وقيمة تيار القاعدة عالية بما يكفي لوصول تيار المجمع إلى أقصى قيمة، وتيار التشبع يعطى بالمعادلة التالية:

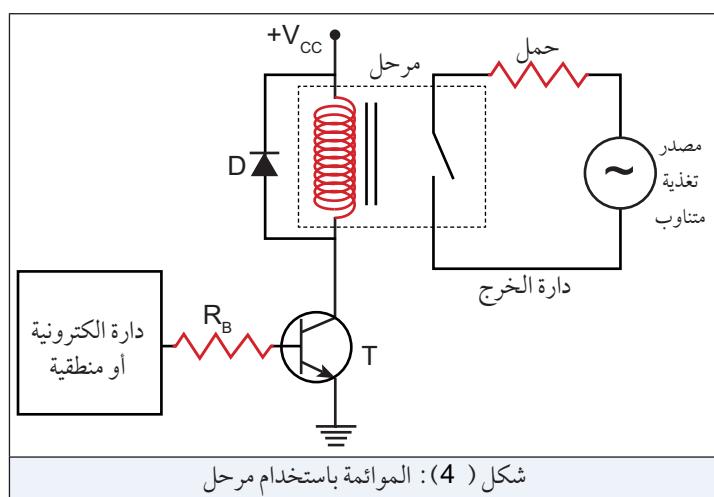
$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C}$$

قيمة الجهد $V_{CE(sat)}$ تكون صغير جداً بالمقارنة بقيمة جهد المصدر V_{CC} وفي العادة يتم إهمالها. القيمة الصغرى لتيار القاعدة التي ينتج عنها التشبع تعطى بالعلاقة التالية:

$$I_{B(min)} = \frac{I_{C(sat)}}{\beta_{dc}}$$

للتأكد من الوصول لمنطقة التشبع لابد أن يكون I_B أعلى من $I_{B(min)}$.

3- ربط دارات منطقية مع الأحمال باستخدام المرحل

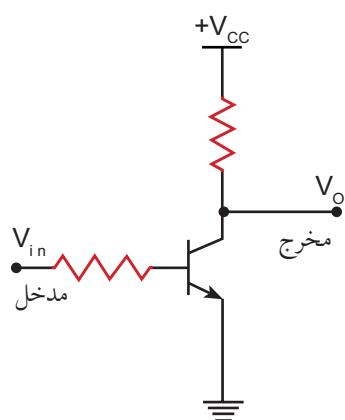


يبين الشكل (4) دارة التحكم باستخدام ترانزستور ومرحل حيث يتحكم بالحمل عن طريق الترانزستور والمرحل (relay)، تعمل الدارة المنطقية (أو الالكترونية) على توصيل المفتاح الترانزستوري، مما يؤدي إلى مرور تيار المجمع بملف المرحل، ويتيح عن ذلك غلق ملامسات المرحل ثم مرور تيار بداره الحمل.

لماذا يستخدم الترانزستور هنا؟

إن ملف المرحل يحتاج إلى تيار عالي لا تستطيع الدارات المنطقية توفيره، لذلك يستخدم الترانزستور لتضخيم تيار دارة التحكم (الدارة الالكترونية أو المنطقية) بحيث يمكن أن يعمل المرحل على توصيل دارة الحمل بشكل فعال. ويعمل الثنائي الموصل بالتوازي مع المرحل على حماية الدارة من التيارات الراجعة عند القطع المفاجئ للترانزستور.

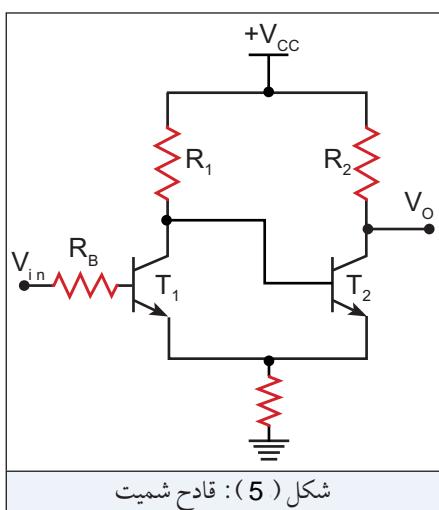
4 - البوابات المنطقية :



يمكن الاستفادة من حالة الوصل والفصل للترانزستور في عمل الدارات المنطقية حيث تعتبر حالة الوصل الحالة المنطقية 1 و تكون حالة الفصل الحالة المنطقية 0 .

من الأمثلة على ذلك الدارة المنطقية «لا NOT» حيث تكون حالة المخرج معاكسة لحالة المدخل ويوضح الشكل التالي الدارة المنطقية لا Not باستخدام الترانزستور .

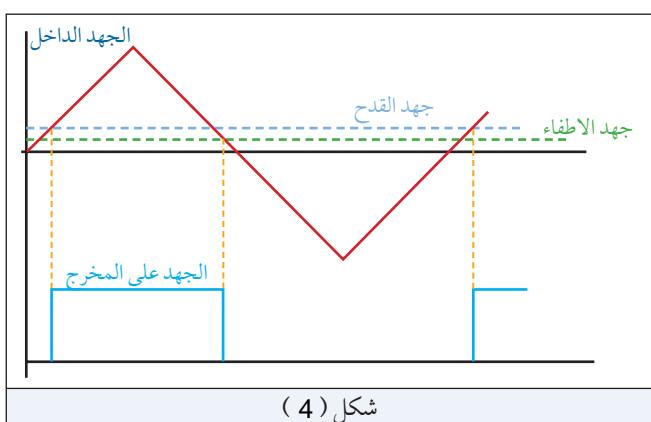
5 - دارة تشكيل النبضات الكهربائية (قادح شميت Schmitt Trigger)



هي دارة تستخدم لإعادة تشكيل النبضات الكهربائية ذات الحفافات غير الحادة مما يمكن الحصول على موجات مربعة أو مستطيلة بغض النظر عن شكل موجة الدخل الأصلية . ويبين الشكل (5) تركيب الدارة .

مبدأ العمل : عند غياب إشارة المدخل V_{in} أو انخفاض في جهد القدح يكون الترانزستور T_1 في حالة قطع وترتفع فولطية مجتمعه ، مما يؤدي إلى عمل الترانزستور T_2 بحيث يصبح في حالة الوصل . فيكون جهد الخرج يساوي تقريرياً الصفر .

وعندارتفاع فولطية المدخل V_{in} (حيث تكون أكبر من فولطية القدح



للترانزستور T_1 يصبح الترانزستور T_1 في حالة التوصيل وتنخفض فولطية مجتمعه ، مما يؤدي إلى فصل الترانزستور T_2 وتحوله القطع ، فيكون جهد

الخرج يساوي جهد المصدر . وهكذا .
فتكون فولطية الخرج بين قيمة عظمى هي V_{cc} وقيمة صغرى تقريرياً صفر . ويوضح الشكل (4) مثال على إشارة الدخل و كيف تكون إشارة الخرج .

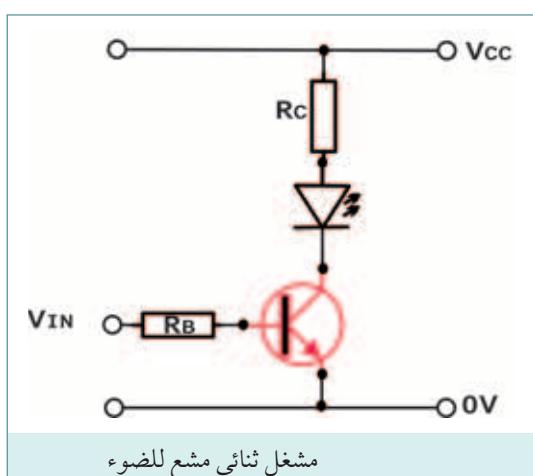
6 - القدرة المبددة في المفتاح الترانزستوري:

بصورة عامة ، القدرة المبددة في الترانزستور تساوي حاصل ضرب تيار المجمع (I_c) بجهد المجمع الباعث

$$P = I_c \times V_{CE} \quad \text{أي: } V_{CE}$$

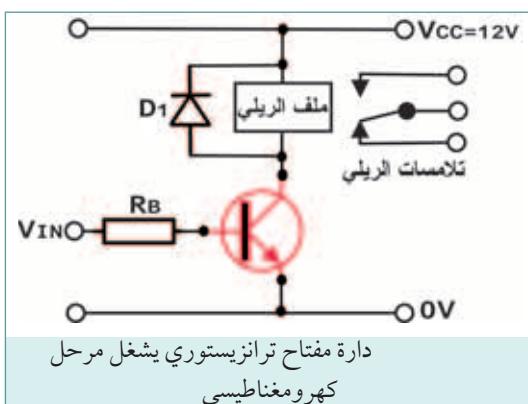
وعندما يكون الترانزستور في حالة القطع تكون قيمة تيار المجمع منخفضة جداً ، وبالتالي تكون قيمة القدرة المبددة في الترانزستور منخفضة جداً أيضاً . وعندما يكون الترانزستور في حالة الوصل تكون قيمة جهد المجمع الباعث منخفضة جداً (0.2 فول特 تقريرياً) ، وبالتالي تكون قيمة القدرة المبددة في الترانزستور منخفضة جداً أيضاً . وهكذا نستنتج أن القدرة المبددة في الترانزستور عند عمله كمفتاح منخفضة جداً .

7 - تطبيقات المفاتيح الترانزستورية:



للمفاتيح الترانزستورية تطبيقات واسعة من أهمها تشغيل مصابيح الإشارة ، وال الثنائيات المشعة للضوء (LED)

كما تستخدم المفاتيح الترانزستورية لربط دارات القدرة ذات التوترات العالية بالدارات الإلكترونية ذات التوترات المنخفضة، وكمثال على ذلك يبين الشكل دارة تحكم بحمل كهربائي عن طريق مفتاح ترانزستور ومرحل (Re-lay) يمكن أن تعمل الدارة الإلكترونية (ميكروكمبيوتر مثلاً) على توصيل المفتاح الترانزستوري مما يؤدي إلى مرور تيار المجمع عبر ملف المرحل. ويتيح عن ذلك غلق ملامسات المرحل ومرور التيار في الحمل الكهربائي، وهو في الغالب حمل صناعي كأن يكون محركاً أو عنصر تسخين أو مصباح إنارة.

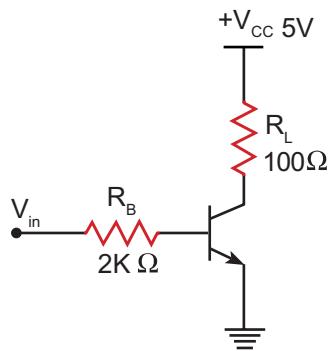


يعمل الثنائي (D) على منع تولد جهد عكسي عالي بين طرفي ملف المرحل عندما يقوم الترانزستور بقطع التيار المار في الملف بصورة فجائية. في حالة عدم استخدام هذا الثنائي يتولد جهد عكسي عالي بين طرفي ملف المرحل قد يؤدي إلى تلف الترانزستور.

مثال :

احسب قيمة المقاومة R_B في الدارة المبينة في الشكل التالي إذا كان $\beta = 10$

الحل :



من المعروف في حالة التشبع يكون $V_{BE} = 0.2$ V و $V_{CE} = 0.2$ V

$$I_{C(SAT)} = \frac{V_{CC} - 0.2}{R_L} = \frac{12 - 0.2}{50} = 0.236A$$

حيث يكون I_C :

ويمكن حساب تيار التشبع من معامل كسب التيار $\beta = \frac{I_C}{I_B}$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.236}{10} = 23.6mA$$

وعليه تكون قيمة المقاومة RB :

$$R_B = \frac{V_{in} - 0.7}{I_B} = \frac{5 - 0.7}{23.6m} = 182.2\Omega$$

مثال :

احسب قيمة جهد الدخل V_{in} اللازم لوضع الترانزستور في حالة التشبع في الدارة المبينة في الشكل (٣٠).

إذا كان معامل الكسب يساوي $\beta = 15$

الحل :

يمكن حساب تيار المجمع :

$$I_{C(SAT)} = \frac{V_{CC} - 0.2}{R_L} = \frac{5 - 0.2}{100} = 49.8 = 5mA$$

و يكون تيار القاعدة :

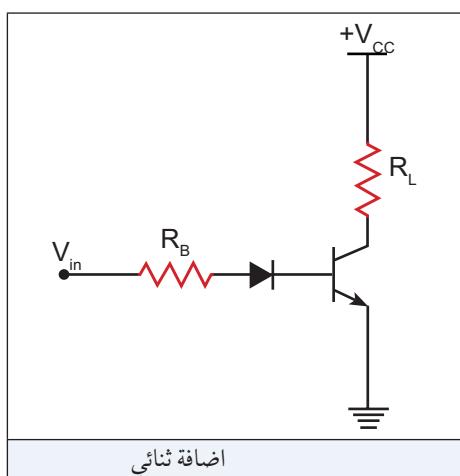
$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{50 m}{15} = 3.3mA$$

ويتم حساب جهد الدخل كالتالي :

$$V_{in} = I_B \times R_B + 0.7 = 3.3m \times 2 k + 0.7 = 7.3 V$$

10- تحسين دارة المفتاح الترانزستوري :

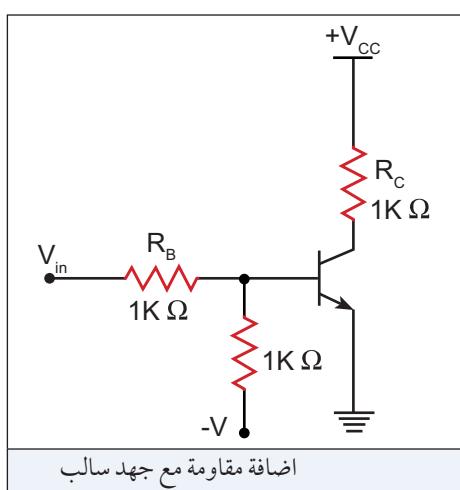
يمكن تحسين دارة المفتاح الترانزستوري بإضافة عنصر أو أكثر ، ويهدف ذلك إلى تحسين أداء الدارة في التطبيقات المختلفة و من هذه التعديلات :-



التعديل بهدف ضمان عمل الترانزستور في منطقة

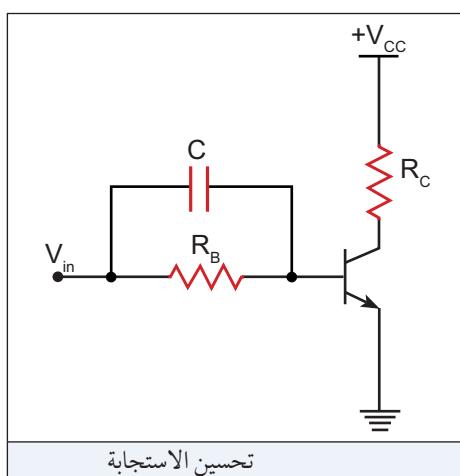
القطع :

لضمان عمل الترانزستور في حالة المفتاح الترانزستوري مع توفير جهد ذو هامش للتغيير للحفاظ على العمل . فعند انخفاض فولطية الدخل V_{in} بحث يكون تيار القاعدة أكبر قليلاً من الصفر ، فإن الترانزستور لا ينتقل إلى منطقة القطع ، بل يكون في المنطقة الفعالة . ويمكن التخلص من هذه الفولطيات الصغيرة بطريقتين :



أ- إضافة الثنائي إلى قاعدة الترانزستور كما في الشكل بهذه الطريقة يتم منع الفولطيات المنخفضة من تشغيل الترانزستور و يتم ضمان إطفائه ، ولكن يجب تعويض الجهد على الثنائي في فولطية الدخل .

ب- إضافة مقاومة مع فولطية سالبة إلى دارة القاعدة حيث تعمل هذه الإضافة على استمرارية الترانزستور في حالة القطع ، وذلك من خلال فولطية سالبة على القاعدة حتى وإن كانت فولطية الدخل أكبر من الصفر ، أما عند ارتفاع فولطية الدخل ، فإن فولطية القاعدة تصبح موجبة مما يتربّط عليه انتقال الترانزستور إلى حالة التوصيل التام - التشبع - .



التعديل بهدف تحسين الاستجابة :

يمكن تحسين الاستجابة لغيرات إشارة الدخل V_{in} عن طريق إضافة الموسوع C لزيادة استجابة دارة المفتاح في حالتي الوصل والفصل كما هو مبين في الشكل

المفتاح الترانزستوري

ترانزستور تأثير المجال: Field Effect Transistor

الوحدة

وضعية تعليمية

تعريف

ترانزستور تأثير المجال هو عنصر ذو ثلاثة أطراف هي: المنبع (SOURCE) والمصرف (DRAIN) والبوابة (GATE) وهذه الأطراف تقابل الباعث والمجمع والقاعدة، على الترتيب، في الترانزستور العادي.

ان التيار بين المنبع والمصرف في ترانزستور تأثير المجال تحكم فيه الفولطية المطبقة على البوابة ، في حين يتحكم بالتيار بين الباعث والمجمع تيار القاعدة . أي أن الترانزستور FET يتحكم فيه بالجهد بينما الترانزستور العادي يتحكم فيه بالتيار .

يعرف ترانزستور تأثير المجال بالترانزستور أحادي القطبية تميزه عن الترانزستور ثنائي القطبية ، لأن التيار المار خلاله يتكون من نوع واحد من حاملات الشحنة ، وهي الالكترونات في ترانزستور تأثير المجال بالقناة السالبة ، أو الفجوات في ترانزستور تأثير المجال بالقناة الموجبة ، بينما ترانزستور الوصلة ثنائية القطبية والذي تم شرحه نجد أن التيار المار خلاله يتكون من كلا النوعين الالكترونات والفجوات .

مميزاته:

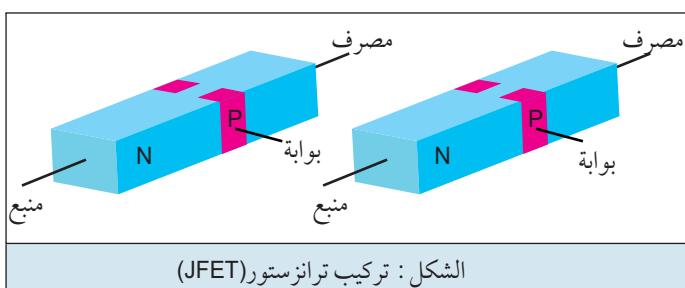
كما يمتاز ترانزستور تأثير المجال على الترانزستور العادي بما يلي :

- 1 يبدي مقاومة مدخل عالية (عدة ميجا أوم) ، لأنه يعتمد على فولطية المدخل بعكس ترانزستور الوصلة ثنائية القطبية الذي يعتمد على تيار المدخل .
- 2 تصنيعه أسهل ، ويحتل مساحة أصغر في الدارات المتكاملة .
- 3 مستوى الشوشرة منخفض بالمقارنة مع ترانزستور الوصلة ثنائية القطبية .
- 4 لا يتأثر بالحرارة مثل ترانزستور الوصلة ثنائية القطبية .

أنواعه:

- 1 ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة (Junction FET:JFET).
- 2 ترانزستور تأثير المجال نوع الأكسيد المعدني (MOSFET) : هذا الاسم يعود إلى بنية الترانزستور ، حيث يتكون من ثلاث طبقات : طبقة معدنية (Metal) ، طبقة من أكسيد السيلikon (Oxide) ، طبقة نصف موصل (Semiconductor).

ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة

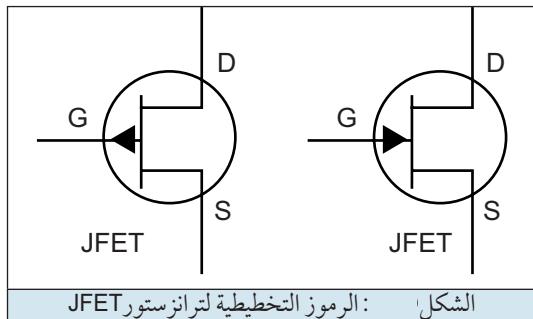


يوجد صنفان رئيسيان من ترانزستور تأثير المجال ذي الوصلة (JFET) وذلك حسب تكوين هذه الترانزستورات ، كما يوضح الشكل، وهما :

ترانزستور JFET بالقناة السالبة. (N)

ترانزستور JFET بالقناة الموجبة. (P)

ويبيّن الشكل التالي التركيب الأساسي للترايود JFET بالقناة السالبة (N) ويتكوّن من شريحة من النوع (N)، تتصل بها أسلاك المنبع (S: Source) والمصرف (D: Drain) تدعى هذه الشريحة باسم القناة (Channel)، يتصل بها طرف سلكي يسمى البوابة (G: Gate)، وهكذا تتشكل وصلة (PN) بين مادة البوابة (P) ومادة القناة (N). (1) يبيّن الشكل (1) أيضاً التركيب الأساسي لترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة بالقناة الموجبة (P)، إذ أن مادة القناة من النوع (P) ومادة البوابة من النوع (N).



ويبيّن الشكل رمز ترانزستور JFET، وتلاحظ أن رأس السهم على سلك البوابة يتجه داخل الترايود بالقناة السالبة ، ويتوجه خارج الترايود بالقناة الموجبة . ونذكر القارئ بأن رأس السهم يشير دائماً إلى المادة من النوع (N) ، تماماً كما هو الحال في الترايود العادي والثاني . ويكون السهم في

منتصف الخط العمودي الذي يمثل القناة ، أو على طرف القناة بالقرب من طرف المنبع .

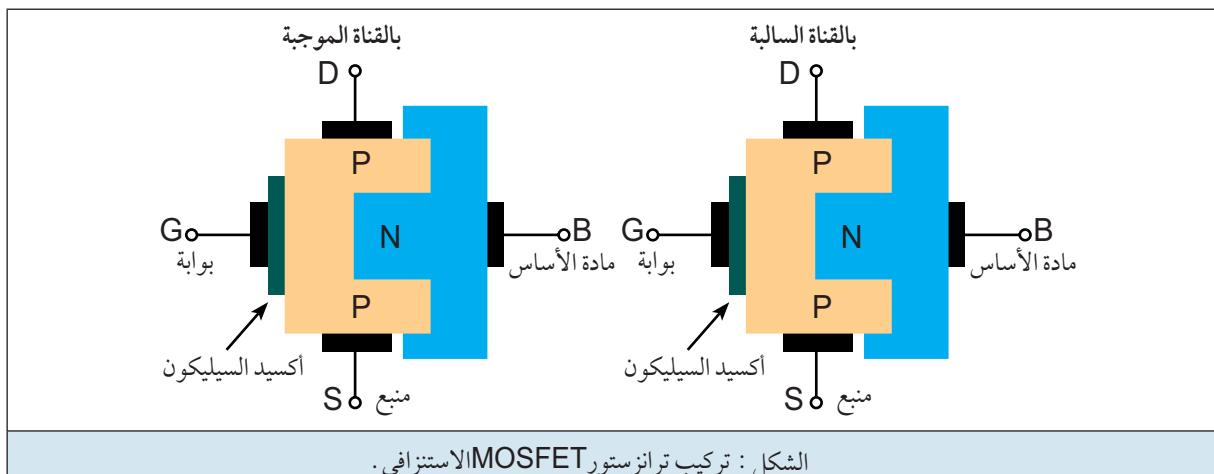
مترانزستور تأثير المجال نوع الأكسيد المعدني MOSFET

يطلق أيضاً على هذا الترانزستور اسم ترانزستور ذو البوابة المعزولة (Insulated Gate FET)، لأن بوابة الترانزستور المعدنية تكون معزولة عن القناة بطبقة عازلة من أكسيد السيليكون، مما يجعل مقاومة دخل هذا الترانزستور عالية جداً. وهناك نوعان من ترانزستور MOSFET، وهما:

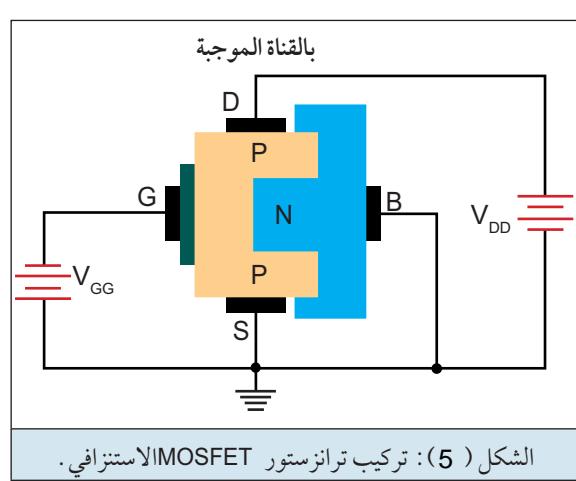
- أ. ترانزستور MOSFET الاستنزافي (Depletion Mode MOSFET : DEMOSFET).
- ب. ترانزستور MOSFET التعزيزي (Enhancement Mode MOSFET : EMOSFET).

أ. ترانزستور MOSFET الاستنزافي (DEMOSFET)

ويبين الشكل التالي بناء الترانزستور DEMOSFET بالقناة السالبة (N)، وبناء الترانزستور DEMOSFET بالقناة الموجبة (P). ونلاحظ أن المنبع والمصرف منتشر في مادة الأساس للترانزستور، ويتصل المنبع والمصرف مع بعضهما بقناة ضيقة ملامسة للبوابة المعزولة، ونلاحظ من الشكل أن البوابة معزولة عن القناة بطبقة من ثاني أكسيد السيليكون (SiO_2). فالقناة والبوابة تشكلان لوحياً مواسع، ويشكل أكسيد السيليكون الطبقة العازلة بينهما.



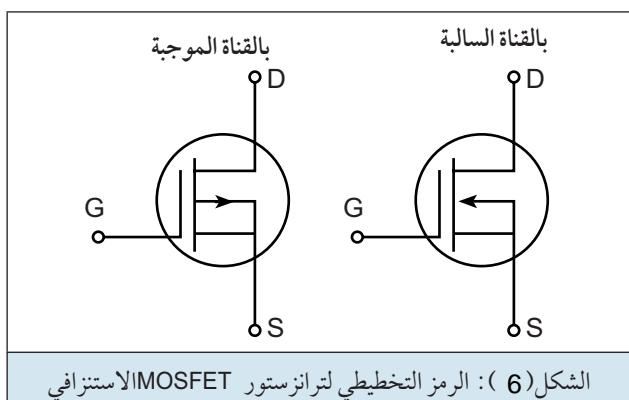
وستتعرف هنا على مبدأ عمل ترانزستور MOSFET الاستنزافي بالقناة السالبة، إذ لا يختلف عن مبدأ عمل ترانزستور MOSFET الاستنزافي بالقناة الموجبة سوى أن فولطيات الانحياز تكون معكوسة. أثناء التشغيل المعتاد للترانزستور DEMOSFET الاستنزافي بالقناة السالبة تطبق فولطية سالبة على المنبع وفولطية موجبة على المصروف، مما يؤدي إلى جريان تيار خلال القناة من المنبع إلى المصروف، لاحظ الشكل (5).



إذا طبقت فولطية سالبة على البوابة، فإن الشحنة السالبة على البوابة سوف تدفع الإلكترونات السالبة في القناة إلى منطقة الأساس الموجبة، نتيجة قوة التناحر بين تلك الإلكترونات في القناة والشحنات السالبة على البوابة. ويسبب ذلك استنزافاً للإلكترونات في القناة، فتزداد مقاومة تلك القناة، ويقل التيار الذي يسري من مصدر الفولطية الموجب إلى المصروف ثم المنبع، وزيادة الفولطية السالبة على البوابة، يؤدي إلى زيادة مقاومة القناة ونقصان التيار وهكذا، وتعرف هذه الحالة بحالة

الاستنزا للترازستور .

أما إذا وصلت فولطية موجبة بالبوابة بدلاً من الفولطية السالبة . فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الالكترونات في القناة



الشكل (6) : الرمز التخطيطي لترانزستور MOSFET الاستنزا

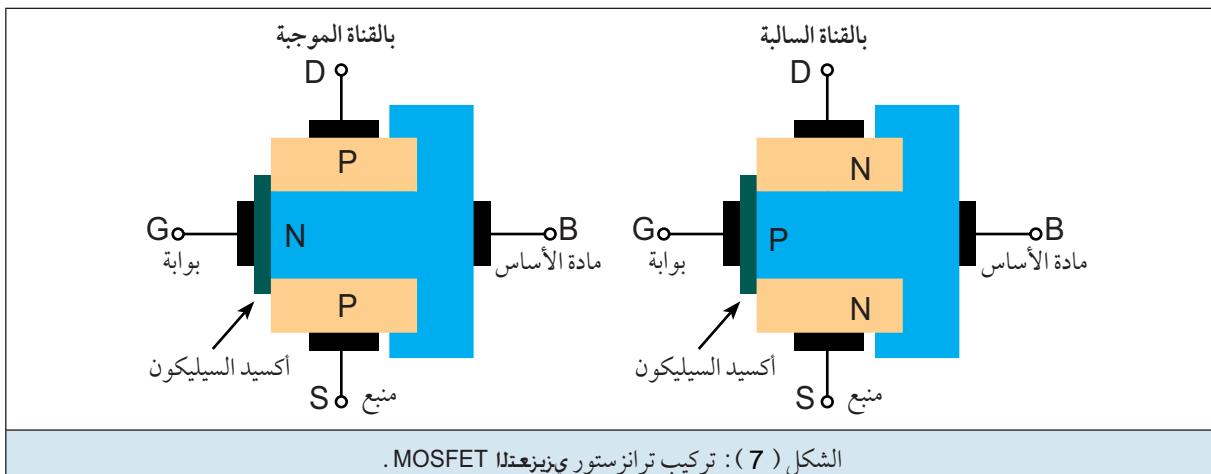
فترداد موصلاتها (تقل مقاومتها) وبذلك يزداد التيار الجاري بين المصرف والمنبع . وتعرف هذه الحالة بالحالة التعزيزية للترازستور . وعلى هذا فإن التيار بين الممنع والمصرف في ترازستور MOSFET الاستنزا يكون محكمًا بالفولطية السالبة أو الموجبة المطبقة على البوابة .

يبين الشكل (6) الرمز التخطيطي لترانزستور MOSFET الاستنزا . لاحظ أن البوابة تظهر

معزولة عن القناة ، ويتميز طرف مادة الأساس بواسطة السهم ، وكما هو الحال دائمًا يشير السهم نحو المادة السالبة (N) حيث أن اتجاه السهم يكون إلى داخل الترازستور بالقناة السالبة ويكون إلى خارج الترازستور بالقناة الموجبة . في الترازستور المبين نلاحظ أن طرف مادة الأساس موصول مع طرف المنبع من الداخل ، إلا أنه في بعض الترازستورات يكون طرف مادة الأساس منفصلًا .

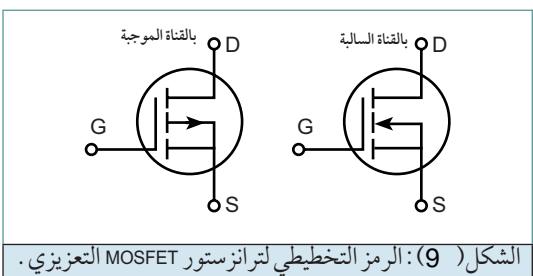
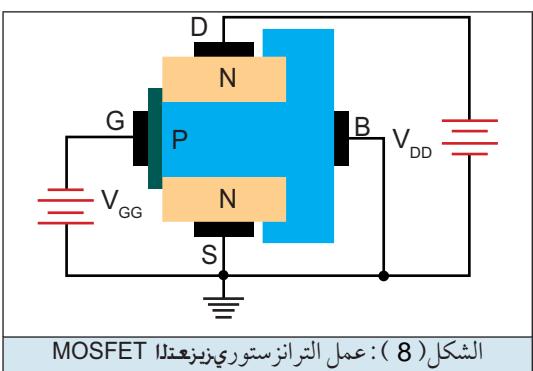
ب. ترازستور MOSFET التعزيزي :

يختلف ترازستور MOSFET التعزيزي في بنائه عن ترازستور MOSFET الاستنزا في أنه لا يحتوي على قناة فيزيائية . ونلاحظ من الشكل (7) أن مادة الأساس تمتد لغاية المادة الفاصلة على البوابة (أكسيد السيليكون) ، ونلاحظ من الشكل كيفية بناء هذا الترازستور ، ففي الوضع الطبيعي ، لا يسري تيار بين المنبع والمصرف إلا بعد أن تتشكل قناة وهمية بين المنبع والمصرف على خلاف ترازستور MOSFET الاستنزا الذي يحتوي على قناة فيزيائية ضمن بنائه باستمرار .



الشكل (7) : تركيب ترازستور يزيدعنه MOSFET .

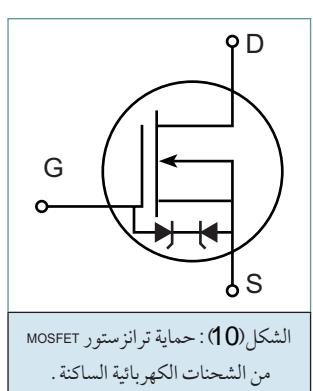
عند تطبيق فولطية موجبة على البوابة كما هو مبين في الشكل (8) ، فإن هذه الفولطية تجذب الالكترونات السالبة من مادة الأساس نحو البوابة ، وتصبح المنطقة المحاذية للبوابة غنية بالالكترونات ، وتصبح كأنها امتداد



ساكنة من روؤس أصابعك تستطيع أن تخترق طبقة الأكسيد. وكاحتياط أمان تقوم الشركات الصانعة بواصل أطراف الترانزستور معا بشكل مؤقت للمحافظة عليه أثناء التداول، ويتم ذلك بغرس أطراف الترانزستور بقطعة من المطاط الموصل. وكذلك الحال بالنسبة للدارات المتكاملة التي تصنع بتقنية MOSFET.

هناك طريقة أخرى لحماية ترانزستور MOSFET من الشحنات الساكنة وهي ربط دايوودي زينر ظهر الظهر بين

طرف في توصيل البوابة. يتم عمل ذلك داخليا كما هو مبين في الشكل (10) وهكذا نضمن أن الفولطية المطبقة على البوابة لن تتجاوز فولطية الزينر أبداً، حيث تقوم دايوود الزينر بالتوصيل لدى بلوغ البوابة فولطية الزينر.



للمادة (N) بين المصرف والمنبع مشكلة قناة وهمية، مما يسمح بسريان التيار بين المنبع والمصرف من خلال هذه القناة. وتؤدي زيادة الفولطية على البوابة إلى زيادة عرض القناة الوهمية، وزيادة تدفق التيار الكهربائي خلال القناة. يبيّن الشكل (9) الرمز التخطيطي لترانزستور MOSFET التعزيزي، لاحظ أنه تم تمثيل القناة الوهمية بخط متقطع، في حين تم تمثيل القناة في الترانزستور الاستنزافي بخط صلب متصل.

هناك مشكلة تواجهنا في ترانزستور MOSFET ألا وهي تطبيق فولطية عالية نسبياً على بوابة الترانزستور قد تثقب الطبقة العازلة الرقيقة، مما يؤدي إلى تلف الترانزستور، ونظرًا لمقاومة البوابة العالية جداً، فإن مجرد تطبيق شحنة

ساكنة من روؤس أصابعك تستطيع أن تخترق طبقة الأكسيد. وكاحتياط أمان تقوم الشركات الصانعة بواصل أطراف الترانزستور معا بشكل مؤقت للمحافظة عليه أثناء التداول، ويتم ذلك بغرس أطراف الترانزستور بقطعة من المطاط الموصل. وكذلك الحال بالنسبة للدارات المتكاملة التي تصنع بتقنية MOSFET.

هناك طريقة أخرى لحماية ترانزستور MOSFET من الشحنات الساكنة وهي ربط دايوودي زينر ظهر الظهر بين

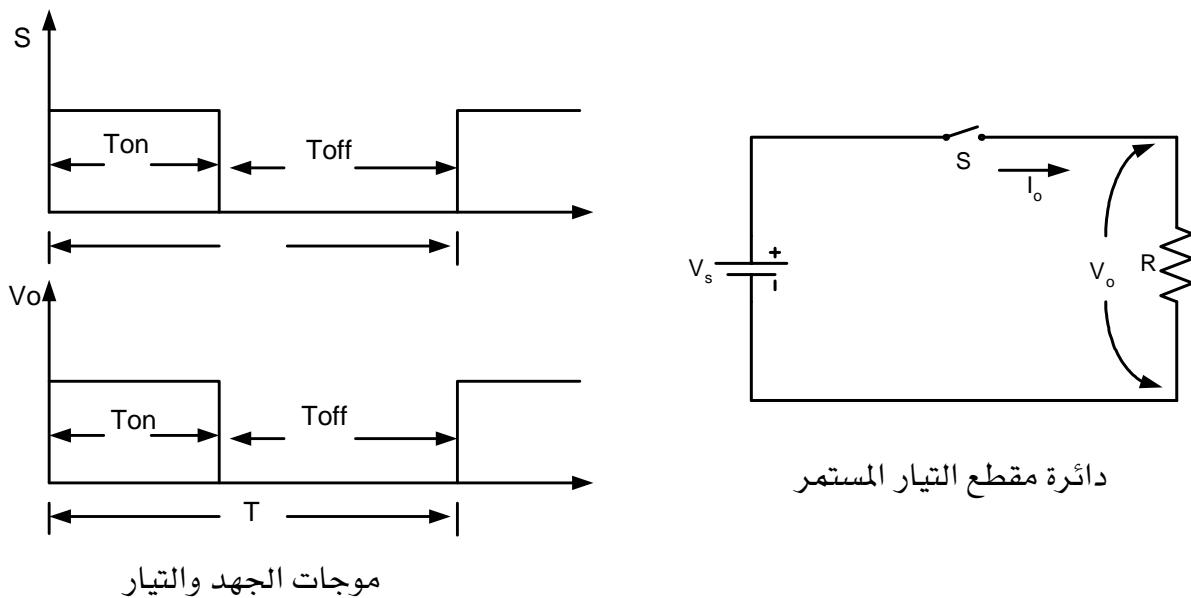
طرف في توصيل البوابة. يتم عمل ذلك داخليا كما هو مبين في الشكل (10) وهكذا نضمن أن الفولطية المطبقة على البوابة لن تتجاوز فولطية الزينر أبداً، حيث تقوم دايوود الزينر بالتوصيل لدى بلوغ البوابة فولطية الزينر.

تطبيقات ترانزستور تأثير المجال DC Choppers: مقطعيات التيار المستمر

تستخدم مقطعيات التيار المستمر للتحويل من تيار مستمر ذو جهد ثابت القيمة إلى تيار مستمر ذو جهد متغير القيمة (محكوم)، وتستخدم مقطعيات التيار المستمر على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية مثل القطارات الكهربائية والسيارات الكهربائية والأوناش....

مبدأ العمل لمقطعيات التيار المستمر

يمكن فهم فكرة عمل مقطع التيار المستمر باستخدام الدائرة الموضحة بشكل المكونة من حمل (عبارة عن مقاومة) ومفتاح ومصدر للتيار المستمر. عند توصيل المفتاح لمدة زمنية مقدارها T_{on} فإن جهد المصدر سيظهر على الحمل، وإذا تم فصل المفتاح لمدة زمنية T_{off} فإن جهد الحمل سيكون مساوياً للصفر، وعلى ذلك تكون أشكال موجات الجهد والتيار كما في شكل



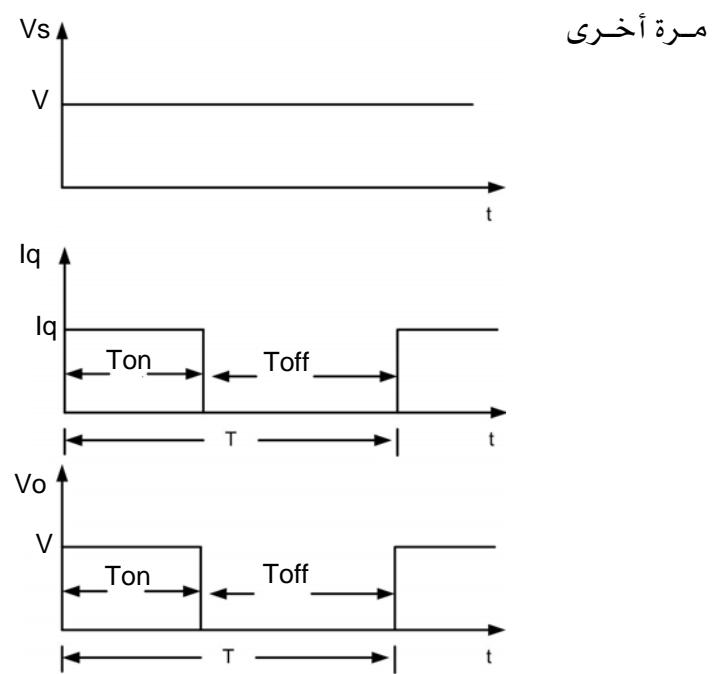
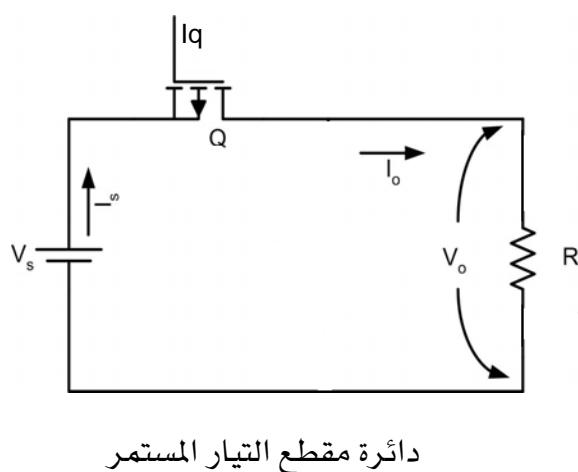
يمكن التحكم في الجهد عن طريق التحكم في نسبة تشغيل المقطع، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن يكون تردد المقطع عالياً لذا يجب أن يكون المفتاح المستخدم أحد عناصر إلكترونيات القدرة مثل ترانزستور القدرة أو MOSFET

مميزات المفتاح (MOSFET)

- أ - ترانزستور موسفت (MOSFET) يتم التحكم فيه بإشارة جهد وليس بإشارة تيار حيث يحتاج لتيار صغير جداً لأشعاله.
- ب - البوابة معزولة عن المصدر بمعنى أنه ليس هناك ارتباط بين تيار البوابة وتيار الحمل.
- ج - يعمل عند ترددات عالية وهذا يسهل عملية تعليم الخرج.

مثال لمفتاح ترانزستوري

عند تشغيل المقطع أي وضع الموسفت في حالة (On) يمر التيار من المصدر إلى الحمل من خلال الموسفت (Q)، أما في حال الفصل أي وضع الموسفت في حالة (Off) فإن التيار يدور في الحمل حتى يتم تشغيل (Q)



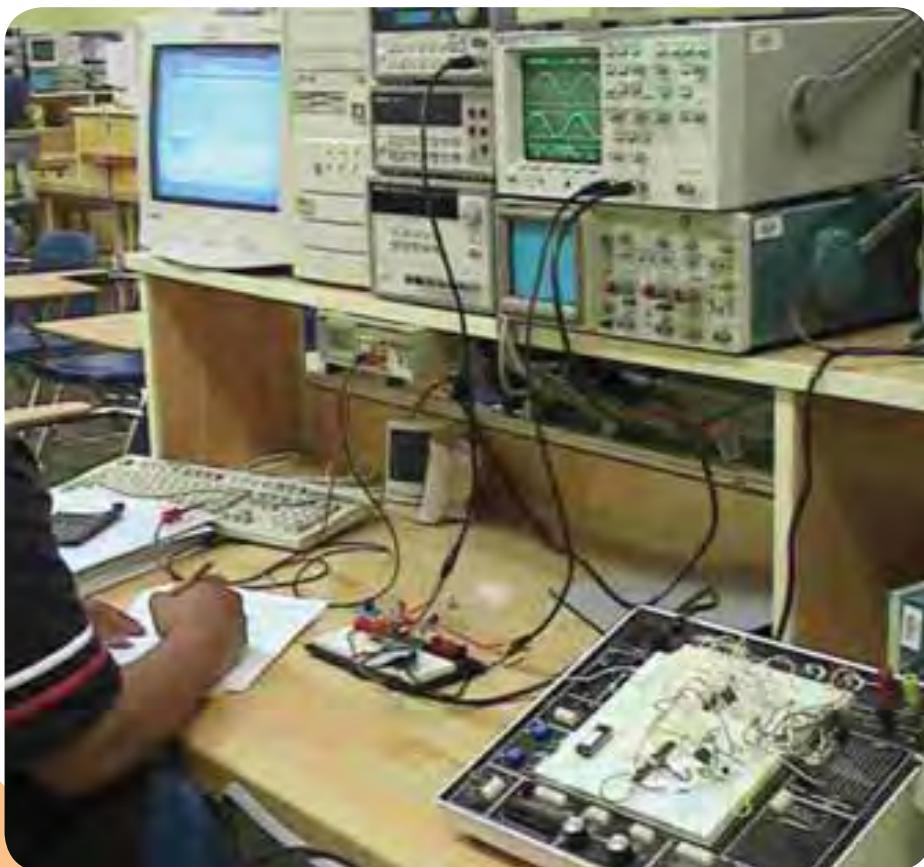
الإلكترونيات الضوئية

1
الوحدة



من تحضير وإعداد
الاستاذ المهندس: لواسف بوفاتح
ثانوية رابح برकاتى
الحى الجنوبى
بلدية افلو
ولاية الأغواط

EMAIL : LOUASSEF@msn.com



وضعية تعليمية

مع تطور علم الإلكترونيات أضحى الضوء أحد العناصر الرئيسية الفعالة المحركة لكثير من التطبيقات العملية، ولقد أضفى الضوء سهولة في البناء والتشغيل على كثير من التطبيقات ودقة أكثر على عمليات التحكم، التي كانت تتم بصعوبة . واستعمل الضوء والاثر العكسي له في بناء عناصر إلكترونية، مثل المقاومة الضوئية، والثنائي الضوئي ، والترانزستور الضوئي ، كما استخدم في وحدات العرض الضوئية. ويستخدم في نقل البيانات في أنظمة الاتصالات عن طريق الألياف الضوئية .

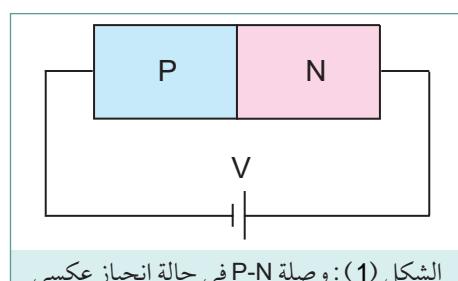
1- الأثر الكهربائي للضوء في أشباه الموصلات:

تكلمنا في الفقرة السابقة عن طبيعة الضوء ولكن كيف يؤثر الضوء في أشباه الموصلات؟
يكون تفسير الضوء على المواد شبة الموصلة في إحدى الظاهرتين الآتتين :

الظاهرة الكهروضوئية (Photoelectric Effect)

عند تعريض مادة شبه موصلة للحزمة ضوئية ، فإن جزءاً من الفوتونات ستخترق المادة في حين أنَّ جزءاً آخر سوف يتصادم (يصطدم) مع إلكترونات المادة فاقداً طاقتها لإلكترونات في مدار التكافؤ (الأبعد عن النواة)؛ حيث يتنقل الكترون من مستوى طاقة منخفض إلى مستوى طاقة أعلى ، فإذا كانت الطاقة المتتصدة من الفوتون كافية فإن هذا الإلكترون يفلت من مداره ويصبح حرّاً ، ويترك مكانه فارغاً (رابطة تساهمية منقوصة «فجوة hole») وبذلك فإن امتصاص فوتون في المادة شبه الموصلة سيكون زوجاً من حاملات الشحنة(فجوة-إلكtron) وبما أن حاملات الشحنة تزداد مع كثافة الضوء الساقط فإن موصلية المادة شبه الموصلة تزداد . فالظاهرة الكهروضوئية تعني «زيادة موصلية المواد شبه الموصلة نتيجة تعرضها للضوء» .

ظاهرة التأثير الكهروضوئي (Photovoltaic Effect)

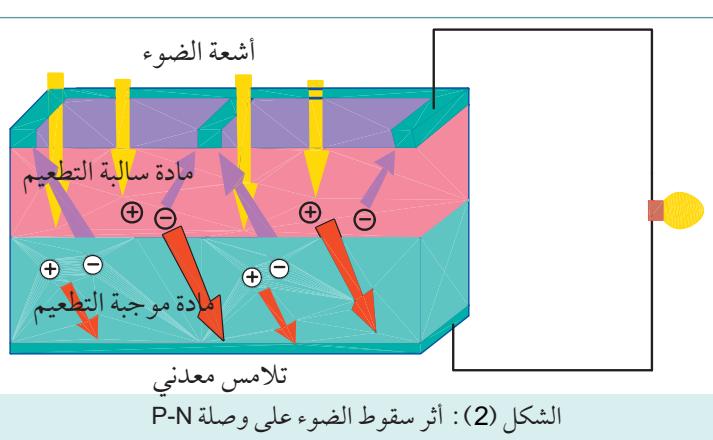


الشكل (1): وصلة N-P في حالة انحياز عكسي

في هذه الظاهرة يتم الحديث عن تَعرُض وصلة من مادة ذات تعليم سالب ومادة ذات تعليم موجب (p-n) للضوء حيث لاحظ العلماء أن تعرّض الوصلة للضوء يولّد قوة دافعة كهربائية على أطرافها وإذا وصل حمل كهربائي بين هذه الأطراف فإن تياراً كهربائياً سوف يسري ، ولتوسيع ذلك سنفترس سلوك وصلة سالب -موجب بالاعتماد على ما مرّ معك في وحدة الثنائيات والظاهرة الكهروضوئية .

إذا كانت الوصلة في حالة انحياز عكسي كما في الشكل (1) فإن عرض منطقة الاسترداد يزداد ولا تعبّر الوصلة إلا حاملات الشحنة الأقلية المتولدة في كلا الطرفين بفعل درجة الحرارة ، حيث تعبّر حاملات الشحنة الأقلية في المادة ذات التعليم الموجب (الإلكترونات) باتجاه المادة ذات التعليم السالب ، وفي حين تعبّر حاملات الشحنة الأقلية في المادة ذات التعليم السالب (الفجوات) باتجاه المادة ذات التعليم الموجب . ويعرف التيار الناتج عن هذه الحركة بتيار الظلام (Dark current) .

عندما تصطدم فوتونات الضوء بشريحة سالب - موجب فإن الطاقة الممتصة من هذه الفوتونات تسبب انفلات بعض الإلكترونات مدار التكافؤ مولدة أزواج من الألكترونات والفجوات (Electron - hole pair) في كل من جزئي الشريحة فتزداد عدد حاملات الشحنة الأكثري والأقلية بنفس العدد.



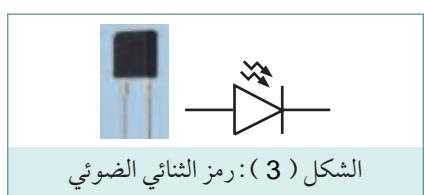
الشكل (2): أثر سقوط الضوء على وصلة P-N

وبذلك تكون نسبة الزيادة أكثر على شحنات الأقلية ولكون الوصلة في حالة انحياز عكسي فإن تيار التسرب العكسي يزداد، وإذا كانت الوصلة في دارة مفتوحة فإن قوة دافعة كهربائية تتولد على أطراف الوصلة وبالاعتماد على هاتين الظاهرتين تم بناء العديد من العناصر الإلكترونية الضوئية والتي ستناول بعضًا منها فيما يأتي :

2 - الثنائي الضوئي PHOTO DIODE

يعد الثنائي الضوئي أحد العناصر الضوئية، ويعمل الثنائي على ظاهرة التأثير الكهربائي الضوئي (Photovoltaic Effect)؛ إذ يعمل الضوء على زيادة تيار التسرب العكسي المار في الثنائي الموصل في حالة انحياز عكسي . فالثنائي الموصل في حالة انحياز عكسي له مقاومة عالية ، ولكن سرعان ما تتناقص مقاومته عند سقوط الضوء . ويتناصف تيار التسرب العكسي طردياً مع شدة الإضاءة الساقطة عليه .

للاستفادة من الثنائي الضوئي كمجس ضوئي يتم وصله في حالة انحياز عكسي في الدارات الإلكترونية ونظرًا لصغر قيمة تيار التسرب العكسي يوصل الثنائي الضوئي مع دارة تضخيم مناسبة .



الشكل (3): رمز الثنائي الضوئي

يعمل الثنائي الضوئي عمل الثنائي العادي في الظلام . يشبه الثنائي الضوئي الثنائي العادي من حيث الأخطال ومحددات التشغيل كالقدرة وجهد التشغيل العكسي وطرق الفحص ، ويرمز له في الدارات الإلكترونية بالرمز كما في الشكل (3) :

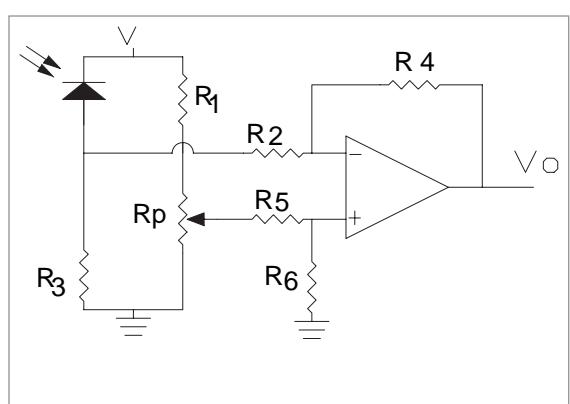
للثنائي الضوئي تطبيقات كتلك التي تستخدم فيها المقاومة الضوئية ، ولكن ما يميز الثنائي الضوئي هو أن استجابته للضوء تكون بشكل خطى مما يجعله مناسباً لقياسات الدقة المتعلقة بالضوء .

مثال :

تحويل شدة الضوء إلى فرق جهد :

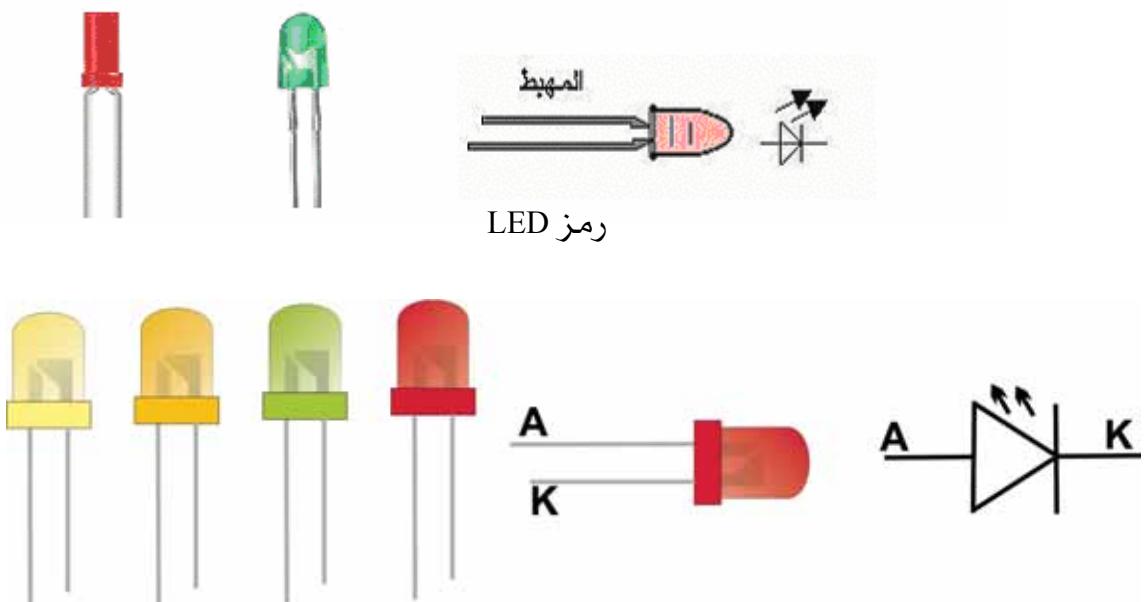
باستخدام قنطرة ويستتون كما في الشكل يمكن تحويل شدة الإضاءة إلى فرق في الجهد ومن ثم إدخالها على دارة تكبير مناسبة (حسب التطبيق) ، إذا كانت الدار معتمة (لا يوجد ضوء) يكون التيار العكسي أقل مما يكون ، فيعمل على تغيير قيمة المقاومة المترتبة حتى نحصل على جهد خرج يساوي صفرًا .

عند ارتفاع شدة الإضاءة يمر تيار عكسي في الثنائي الضوئي يتنااسب مع شدة الإضاءة ويرتفع الجهد على المخرج . يتناسب ارتفاع الجهد على المخرج طردياً مع شدة الإضاءة وبشكل خطى .



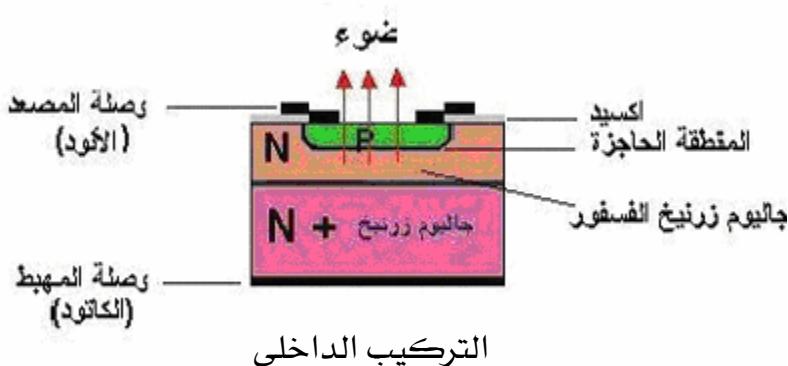
3- ثنايٍ إنبعاث الضوء (LIGHT EMITTING DIODE) LED

يقوم الدياود الباعث للضوء بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية



الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة

التركيب :



يوضح شكل التركيب الداخلي للثنايٍ إنبعاث الضوء LED حيث إنه يشبه في تركيبه تركيب الدياود العادي غير أنه يصنع من مادة فوسفات الجاليم بينما يصنع الدياود العادي من السليكون أو الجermanيوم .

مبدأ العمل

كما هو معروف توجد ثلاثة مستويات للطاقة في شبه الموصل هي طاقة توصيل طاقة تكافؤ يفصل بينهما نطاق المحظور . عند تطبيق جهد أمامي على LED فإن الشحنات تتحرك خلال الحاجز الفاصل بين طرفي الدياود وبالتالي فإنها تعبر مستويات طاقة مختلفة. هذه الشحنات اكتسبت طاقة أشاء توليد أزواج من الالكترونات والفحوات ستفد هذه الطاقة على شكل ضوء عند إعادة اتحاد الالكترونات مع الفحوات .

استقطاب الثنائي LED :

في حالة الانحياز الأمامي تمر كمية كافية من التيار تعمل على انبعاث الضوء وذلك إذا كان الجهد المسلط عليه أكبر من جهد التشغيل الأمامي (V_F) والذي يساوي $2V$ تقريباً في النوع المصنوع من فوسفات الجاليوم.

أما في حالة الانحياز العكسي فيمر تيار ضعيف جداً في LED لا ينبع عنده ضوء (الجهد العكسي للثائي الباعث لضوء صغير) ويصنع غطاء LED إما من البلاستيك أو الزجاج ويكون إما أحمر - أخضر - أصفر أو برتقالي. ويعتمد لون الضوء المنبعث من LED على لون المادة المصنوع منها الموحد الباعث للضوء. حيث إن:

جاليوم النتروجين يشع ضوء أزرقاً

جاليوم الفوسفور (نتروجين) يشع ضوءاً أخضرأً

جاليوم زرنيخ الفسفور (تتزوجين) يشع ضوءاً أصفرأً

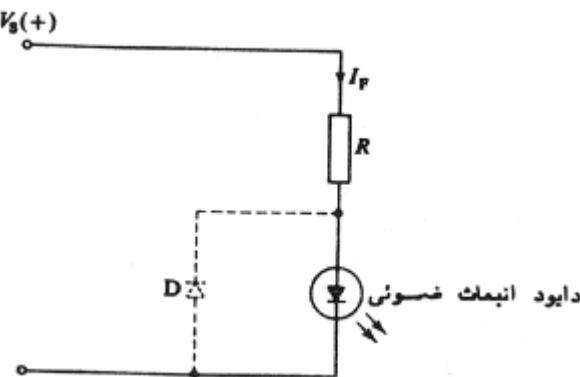
جاليوم زرنيخ الفسفور (تتزوجين) يشع ضوءاً برتقاليأً

جاليوم زرنيخ الفسفور يشع ضوءاً أحمراً

جاليوم الزرنيخ (الزنك) يشع ضوءاً (تحت الحمراء)

جاليوم الزرنيخ (السليكون) يشع ضوءاً (تحت الحمراء)

ولأن LED يعمل على جهد أمامي صغير لا يتعدى بضع من الفولتات توصل معه مقاومة على التوالي تحد من التيار كما يوصل موحد في انحياز عكسي لحمايةه من الجهد العكسي.



بعض استخدامات الثنائي الباعث للضوء :

- في العدادات الرقمية
- في الحاسوب الآلي
- في أنظمة الاتصالات الضوئية
- في دوائر التحذير لمنظومات السيارات
- يستخدم في حاسبات الجيب لإظهار الأرقام والحرروف والإشارات والرموز حيث ترکب مجموعه من 7-SEGMENT LED لتكوين ما يسمى بشرائج السبعة أجزاء

4- المقاومة الضوئية (Photo Resistor LDR)

المقاومة الضوئية هي مقاومة تتغير قيمتها تبعاً للتغيرات كثافة الضوء الساقط على سطحها ، وتناسب قيمتها تناوباً عكسيًا مع شدة الإضاءة ، حيث تتناقص قيمتها عند تعرضها للضوء ، ويمكن تفسير ذلك بالاعتماد على الظاهرة الكهروضوئية .

تركيب المقاومة الضوئية : تصنع المقاومة الضوئية من مادة شبه موصلة حساسة للضوء تطلی بشكل متعرج (لزيادة سطح المقاومة المعرض للضوء) على قاعدة عازلة وتغلف بغلاف شفاف يسمح بمرور الضوء ويتصل طرفاً المادة شبه الموصلة بتلامسين معدنيين يشكلاان أطراف التوصيل الخارجية للمقاومة الضوئية كما في الشكل(3).

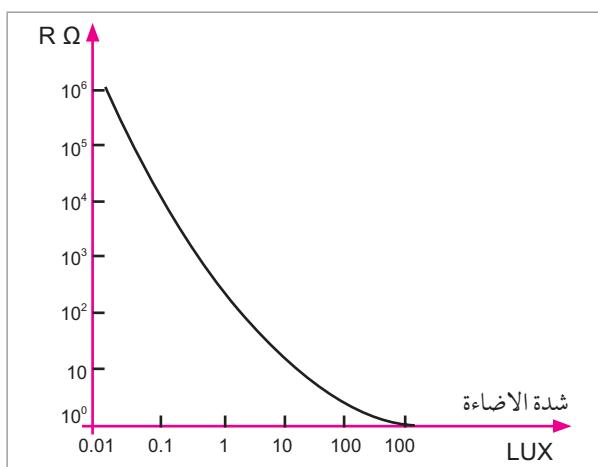


شكل (3):

يرمز للمقاومة الضوئية بالرمز المبين في الشكل (3) وتعرف في التطبيقات العملية بسميات مختلفة كالخلية الكهروضوئية (Photo Electric Cell) ، والموصل الضوئي (Photo Conductor) ، والمقاومة المعتمدة على الضوء (Light Dependent Resistor 'LDR') وتعدّ الأخيرة الأكثر شيوعاً. المقاومة الضوئية حساسة ل WAVES الضوء المختلفة وتعتمد حساسيتها ومدى استجابتها لنوع الأشعة على المادة التي تصنع منها المقاومة الضوئية ، ومن أشهرها :

أ- المقاومة المصنوعة من مادة كبريتيد الكادميوم CdS أو من بلورات الرصاص Lead Crystals التي تستجيب للطيف المرئي .

ب- المقاومة المصنوعة من بلورات سيليانياد الكادميوم التي تستجيب للأشعة الحمراء والأشعة تحت الحمراء .



شكل (4) منحنى يبين قيمة المقاومة مع شدة الإضاءة

ت- المقاومة المصنوعة من كبريتيد الرصاص التي تستجيب للأشعة تحت الحمراء .

تكون المقاومة الضوئية في الظلام عالية جداً ، وعند سقوط الضوء عليها فإن مقاومتها تتناقص (تناسباً عكسيًا مع شدة الإضاءة) حتى تصبح كأنها موصل ، ولا يكون التغيير بشكل خططي لاحظ الشكل (4) .

والمقاومة الضوئية تعامل كالمقاومة العادية

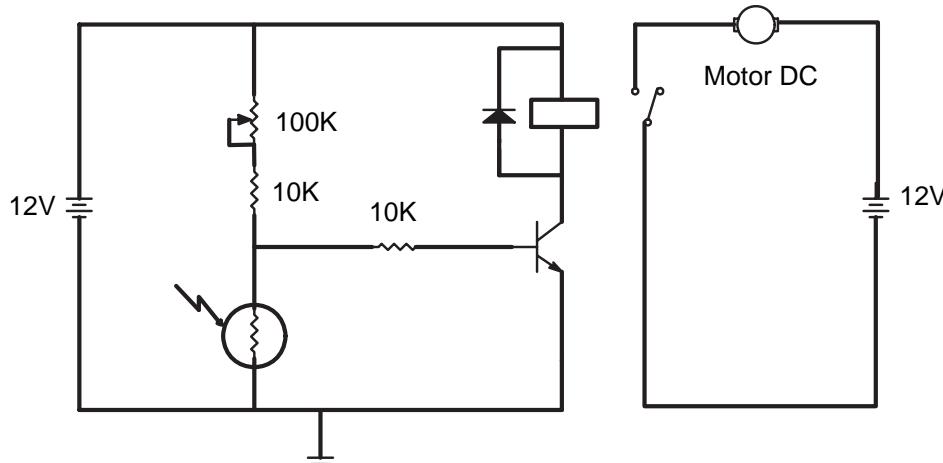
من حيث ظروف التشغيل الواجب مراعاتها خصوصاً القدرة وكذلك من حيث الأعطال .

من مساوى المقاومات الضوئية أنها بطيئة الاستجابة، وتعمل فقط على ترددات منخفضة.

■
تستعمل المقاومات الضوئية في كثير من التطبيقات

هذه التطبيقات أنظمة التحكم المعتمدة على وجود الضوء أو عدمه مثل : التحكم في إنارة الشوارع ليلاً، التحكم الآلي وأجهزة الإنذار (مثل الإنذار بوجود حريق، إنذار ضد السرقة) .

مثال: الشكل (4) يبين دارة تحكم بتشغيل حمل كهربائي باستخدام الضوء .



الشكل (4) : دارة التحكم في تشغيل محرك باستخدام المقاومة الضوئية

عمل الدارة:

يعدّ الضوء العامل الأساسي للتحكم في تشغيل الدارة فعندما تكون شدة الإضاءة عالية فإنَّ قيمة المقاومة الضوئية تكون منخفضة حيث تحدد قيمة الجهد الكهربائي على قاعدة الترانزستور من خلال مجزئ الفولتية المكون من المقاومة المتغيرة والمقاومة الثابتة وقيمة المقاومة الضوئية ولكن المقاومة الضوئية في هذه الحالة منخفضة القيمة فإن الجهد عليها يكون منخفضاً القيمة ، وغير كافٍ لتوفير انحصار للترانزستور الذي يبقى في حالة فصل ولا يعمل الحمل المتصل بالمرحلة .

أما عندما تكون شدة الإضاءة منخفضة فإنَّ قيمة المقاومة الضوئية تكون عالية، وتحدد قيمة الجهد الكهربائي على قاعدة الترانزستور من خلال مجزئ الفولتية المكون من المقاومة المتغيرة والمقاومة الثابتة وقيمة المقاومة الضوئية ولكن المقاومة الضوئية في هذه الحالة عالية القيمة فان الجهد عليها يكون عالياً وكافياً لتوفير انحصار للترانزستور الذي يتحول إلى حالة وصل فيمر تيار في ملف المرحلة فيغير من وضع تلامساته، وبذلك يعمل الحمل المتصل به .

1-5 - مقدمة:

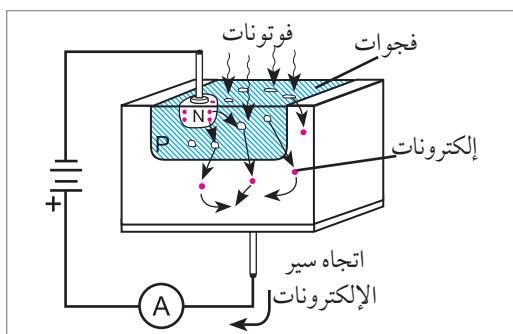
الترانزستورات الضوئية هي ترانزستورات حساسة للضوء، والنوع الشائع للترانزستور الضوئي يشبه الترانزستور ثنائي القطبية ولكن بدون طرف القاعدة الذي يستبدل بسطح حساس للضوء. ويشبه عمل الترانزستور الضوئي عمل الترانزستور العادي إلا أنه يعتمد على الظاهرة الفولتية الضوئية حيث إن تيار القاعدة يتولد بالضوء ويتناوب مع شدة الإضاءة على السطح الحساس للضوء.



الترانزستور الضوئي

عند وضع الترانزستور الضوئي في الظلام يصبح في حالة قطع ولا يمر تيار بين المجمع والباعث وعند تعرض السطح الحساس للضوء يمر تيار قاعدة صغير ينبع عن ذلك تيار كبير يمر بين المجمع والباعث. كما توجد أيضاً ترانزستورات تأثير المجال الضوئية التي تستخدم التأثير الضوئي في توليد جهد البوابة الذي يتحكم بتيار المصرف (Drain) - المنبع (Source).

2- آلية عمل الترانزستور الضوئي:



الشكل (6) : رمز الترانزستور الضوئي ذي الطرفين وأآلية عمله

يبين الشكل (6) ترانزستوراً ضوئياً ذات طرفي ثقابي القطبية موصول مع مصدر جهد على طرفيه (المجمع والباعث) وكما ذكرنا سابقاً يشبه عمله عمل الترانزستور ثنائي القطبية نوع NPN العادي إلا أن طبقة القاعدة P كبيرة، وعند تعرضها للضوء تصطدم فوتونات الضوء مع الكترونات المادة P فتكسبها طاقة كافية للتتجاوز حاجز منطقة الاستنزاف لتصل إلى منطقة المجمع N وتترك مكانها أيونات موجبة سرعان ما تجذب إليها إلكترونات الباعث N ونتيجة لذلك يتشكل تيار كهربائي يمر من المجمع إلى الباعث.

3- أنواع الترانزستورات الضوئية:

الترانزستورات الضوئية ذات الثلاثة أطراف:

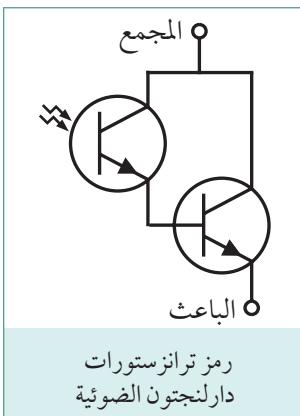
بما أن الترانزستورات الضوئية ذات الطرفين غير قادرة على توليد تيار في القاعدة كافٍ للحصول على تيار مجمع - باعث مناسب، فهناك ترانزستورات ذات ثلاثة أطراف بإضافة طرف القاعدة الذي يستخدم لتشبيط انحياز الترانزستور بحيث يمكن من التحكم في حساسيته للضوء.

رمز الترانزستور
الضوئي ذات الثلاثة أطراف

ويمكن أن يستخدم الترانزستور الضوئي ذات الثلاثة أطراف في التطبيقات باستخدام طرفيين فقط بدلاً من الترانزستورات الضوئية ذات الطرفين بدون استخدام طرف القاعدة.

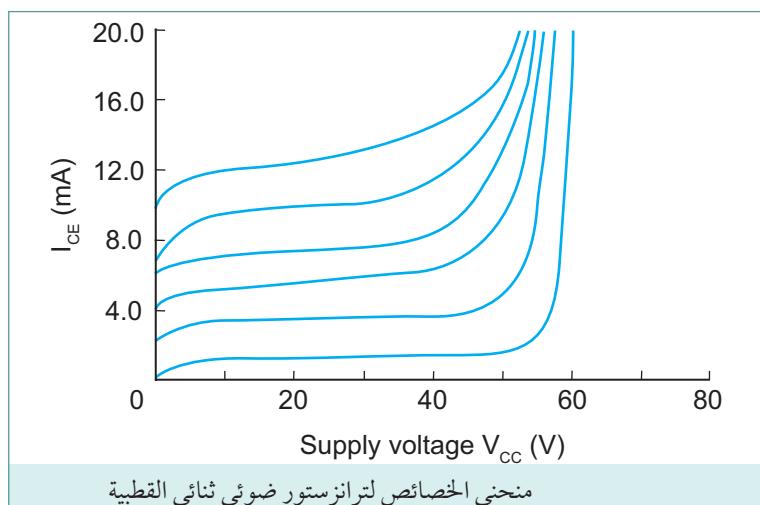
٤-٥- ترانزستورات دارلنجلتون الضوئية:

يمكن توصيل ترانزستور عادي مع ترانزستور ضوئي لاستفاد من خاصية توصيلية دارلنجلتون بالإضافة إلى الخاصية الضوئية بحيث تشبه آلية عمل ترانزستورات دارلنجلتون ثنائية القطبية بالإضافة إلى حساسيته للضوء، لكن بزمن استجابة كبير نسبياً، وتتوفر هذه الترانزستورات بргل قاعدة أو بدونها.



٤-٥- الموصفات الفنية للترانزستورات الضوئية:

للترانزستورات الضوئية كما للترانزستورات العادية جهد انهاير ومعدلات جهد وتيار تشغيل ومنحنى خصائص. وكما يعتمد تيار المجمع I_C على كثافة الإشعاع الساقط على قاعدة الترانزستور وعلى كسب التيار (Gain)، وعلى تيار القاعدة الخارجى في الترانزستورات الضوئية ثلاثة الأطراف.

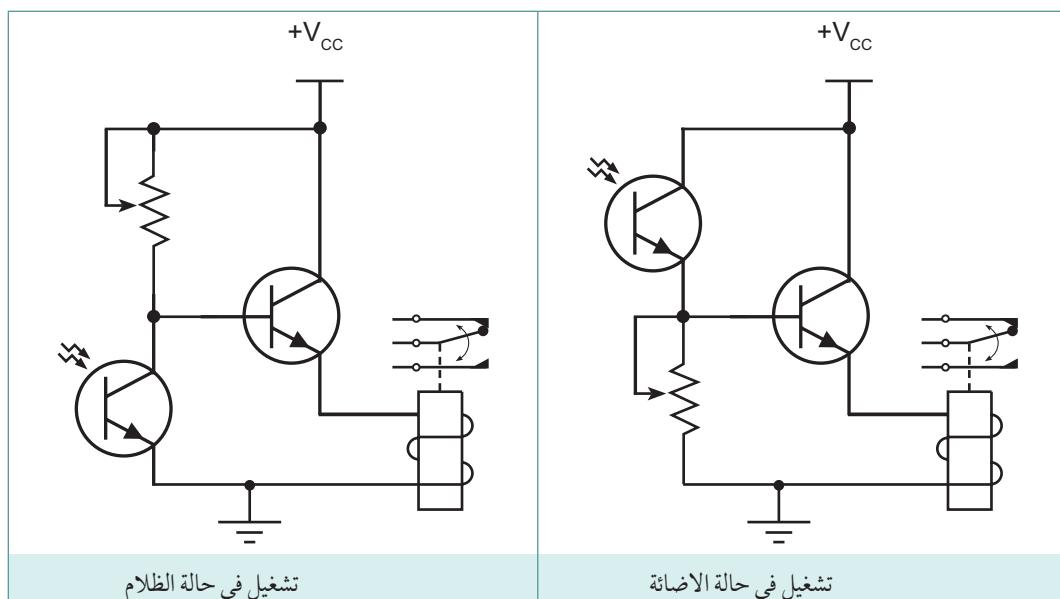


في حالة الظلام التام يمر تيار صغير بين المجمع والباعث يسمى تيار الظلمة (I_d) (dark Current I_d) ويمكن اهماله لصغره (عادة في مجال nA) يبين الشكل الآتى منحنى خصائص الرانزستور الضوئي مبينا العلاقة بين شدة الاشعاع الساقط وتيار المجمع :

٤-٦- تطبيقات على الإلكترونيات الضوئية:

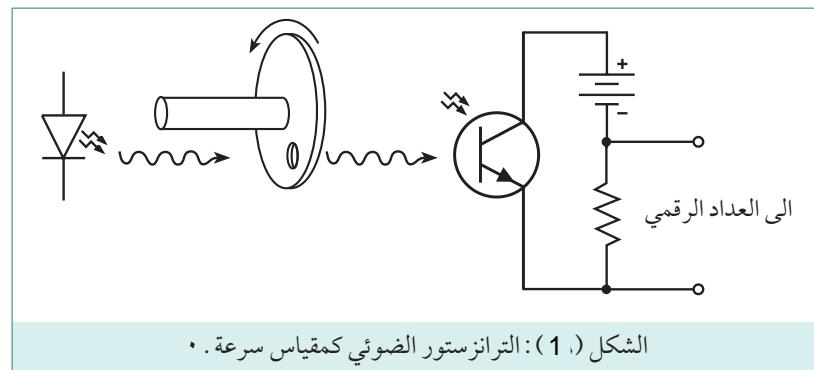
دارات التفعيل الضوئي:

يستخدم الترانزستور الضوئي في عملية تفعيل دارة ما عن طريق تغيير شدة الضوء، وكمثال على ذلك، في الشكل المجاور دارتان تم استخدام الترانزستور الضوئي ليتحكم بتيار القاعدة لترانزستور متصل مع Relay وباختلاف موقع الترانزستور الضوئي نحصل على حالتين للتشغيل تشغيل في حالة الظلام (Dark Activated) وبتشغيل في حالة الاضاءة (Light Activated)



7-5 دارات القياس:

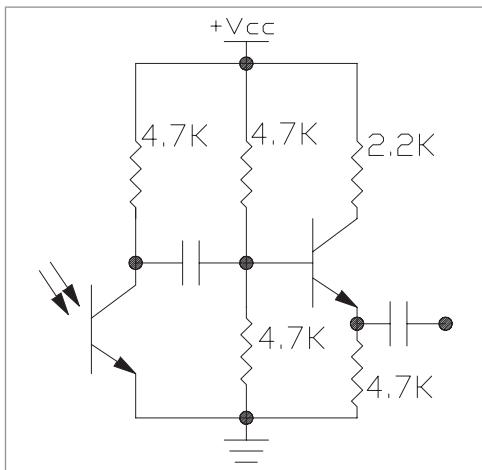
يبين الشكل (1) كيفية استخدام ترانزستور ضوئي كمقياس سرعة دوران أو عدد الدورات، حيث يستخدم قرص دوار فيه ثقب يسمح بمرور الضوء عبارة مرة كل دورة، و يؤدي الضوء المار عبر الثقب إلى قدر الترانزستور الضوئي المتصل بدبوره إلى عداد يعرض سرعة الدوران أو عدد الدورات الكلي.



مثال :

دارات الاستقبال :

يمكن استخدام الترانزستور الضوئي كدارة استقبال لمرسلات ضوئية في تطبيقات التحكم عن بعد Remote control والتي يستخدم فيها غالبا الأشعة تحت الحمراء Infra Red . يبين الشكل (2) دارة يستخدم فيها ترانزستور ضوئي ككافش موجة ضوئية مع مضخم ترانزستوري .



شكل (2)

الملقطات الكهربائية

1
الوحدة

من تحضير وإعداد
الاستاذ المدرس: لواسف بوفاتح
ثانوية رابح برکاتى
الحي الجنوبي
بلدية افلو
ولاية الأغواط

EMAIL : LOUASSEF@msn.com



الملقطات الكهربائية

الوحدة

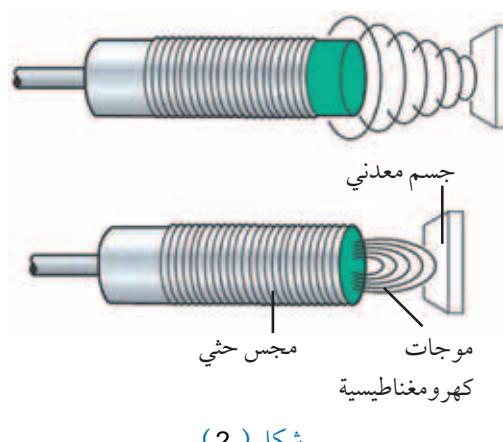
وضعية تعليمية

تعريف

هو عبارة عن عنصر يقوم باستشعار الكميات الفيزيائية كالحرارة، والضغط ، والسرعة ، والحركة ، والقوة ، والضوء ، والصوت ومن ثم تحويلها إلى كميات كهربائية مكافئة لتلك الكميات الفيزيائية .
بإمكانك ملاحظة الكثير من الملقطات في حياتك اليومية كمجس الحرارة الذي يستشعر درجة حرارة الغرفة ، أو الثلاجة ، ويسعى وحدة التحكم بدرجة الحرارة ؛ ليتم ضبط درجة الحرارة بعد ذلك عند المستوى المطلوب والملقط الضوئي الذي يركب على مصابيح الإنارة في الطرق لتنتمي الإنارة عند غيب الشمس .

الملقطات الحثية inductive sensor

هو عبارة عن عنصر يستشعر بوجود الأجسام المعدنية الموجودة في مجاله الكهرومغناطيسي ، وذلك دون اتصال ميكانيكي ، أن المجرس الحسي يضخم الموجة من حيث ارتفاع قمتها الآتية عن طريق الملف والمواسع حيث يلف الملف حول قلب حديدي مفتوح من جهة واحدة كما في الشكل (2) فإذا وجد

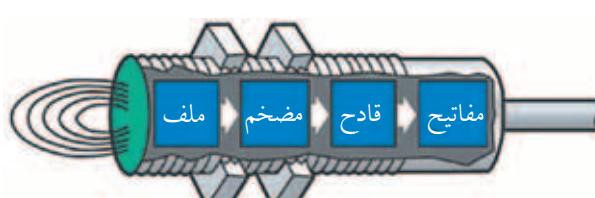


جسم من المعدن في المجال المغناطيسي للملف فإنه ينشأ تيارات إعصارية في هذا الملف نتيجة ارتداد جزء من الموجات الكهرومغناطيسية ؛ مما يؤدي إلى تغيير في قيمة الطاقة داخل الملقط وهكذا يستشعر بوجود أجسام معدنية أم لا في مجال المغناطيسي ، ويكون من :

- أ - ملف كهرومغناطيسي لإصدار موجات كهرومغناطيسية .
- ب - مضخم لتكبير الإشارة المغناطيسية .

- ج - قادر للتحكم بعمل مفاتيح إشارة الخرج .
- د - مفاتيح إشارة الخرج .

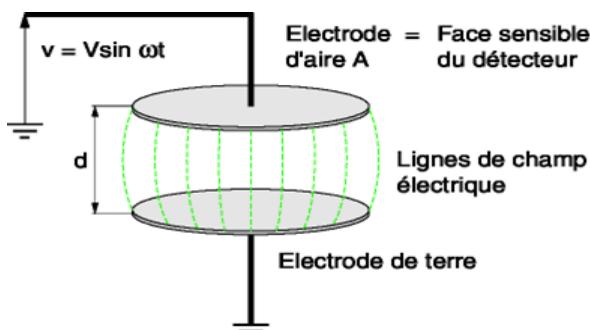
يستخدم هذا المجرس لقياس نسبة الحبر في وحدة التظهير في آلات التصوير الكهروستاني .



المليقطات السعوية

تعريف :

يتكون الرأس الكاشف من لبوسين لمكثفة وتسمح بالكشف عن المواد العازلة او غير العازلة مثل الزجاج و الماء و المواد النلاستيكية

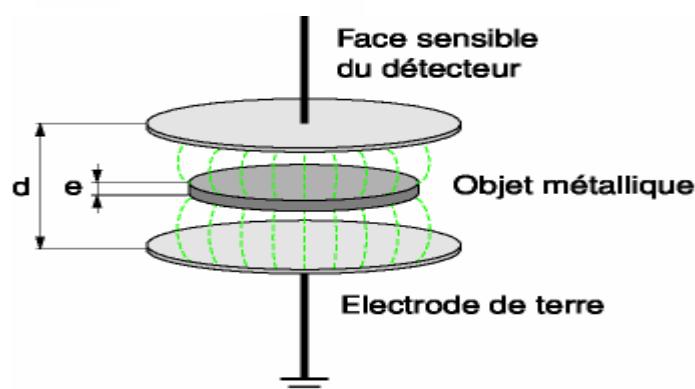


مبدأ العمل :

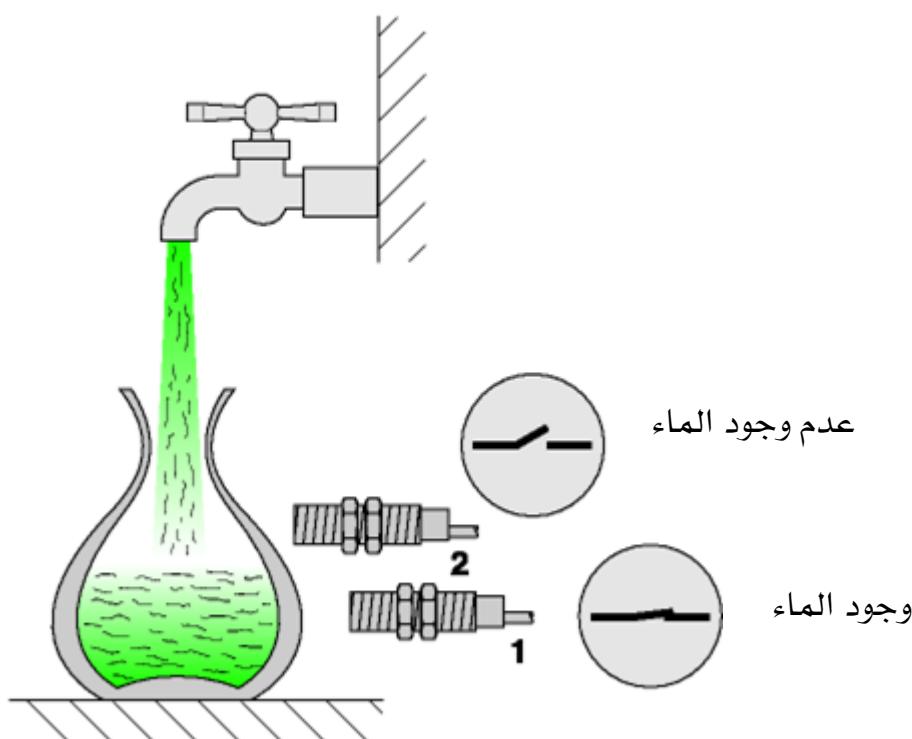
عند توصيل الرأس الكاشف بتيار متذبذب ينشأ حقل كهربائي بين اللبوسين ليحدد قيمة المكثفة C و عند وجود مادة بين اللبوسين ترتفع قيمة المكثفة و تصبح C و بقياس هذه القيمة يمكن الكشف عن المواد

C0 : عدم وجود المادة المطلوب الكشف عنها

C : وجود المادة بين اللبوسين



الكشف عن الماء



الملقطات الضوئية

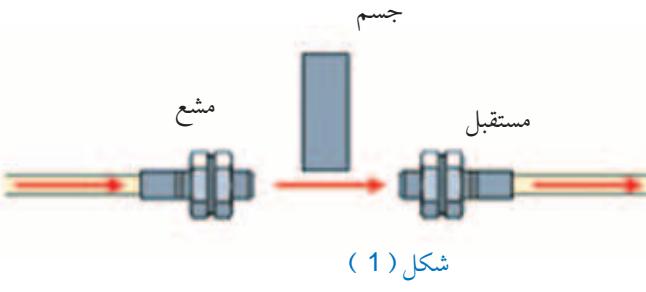
مكونات

يتكون الملقط الضوئي من العناصر الضوئية التي درستها في الفصل الأول (ثنائيات ضوئية ، وترانزسترات ضوئية ، و مقاومات ضوئية وغير ذلك من العناصر الحساسة للضوء) ويوجد بالملقط الضوئي عنصراً أساسياً هما العنصر المشع للضوء ، وهو يحول الإشارة الكهربائية إلى إشارة ضوئية ، والعنصر المستقبل للضوء وهو يحول الإشارة الضوئية إلى إشارة كهربائية ، وهذا العنصران يوضعان معاً في مغلق واحد .

تعريفه

الملقط الضوئي : هو عبارة عن عنصر يقوم باستشعار وجود الأجسام أو عدم وجودها بعدة طرق أهمها:

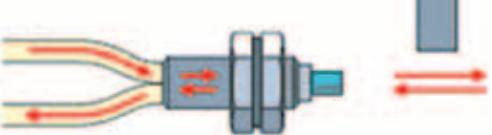
أ- استشعار وجود الجسم عن طريق قطع الإشارة ، وهو أكثر الأنواع



استخداماً حيث يوضع العنصر المشع والمستقبل في صندوق بلاستيكي واحد ، حيث يقابل كل

منهما الآخر ، في الوضع الطبيعي المستقبل يستقبل إشارة من المشع ، أما في حالة وجود جسم بينهما ، فهذا يعني أنه لا تصل إشارة إلى المستقبل ، كما في الشكل (1) .

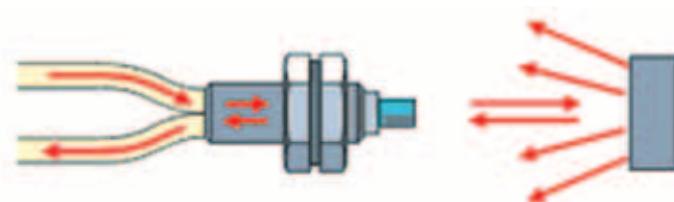
ب- استشعار وجود الجسم عن طريق عكس



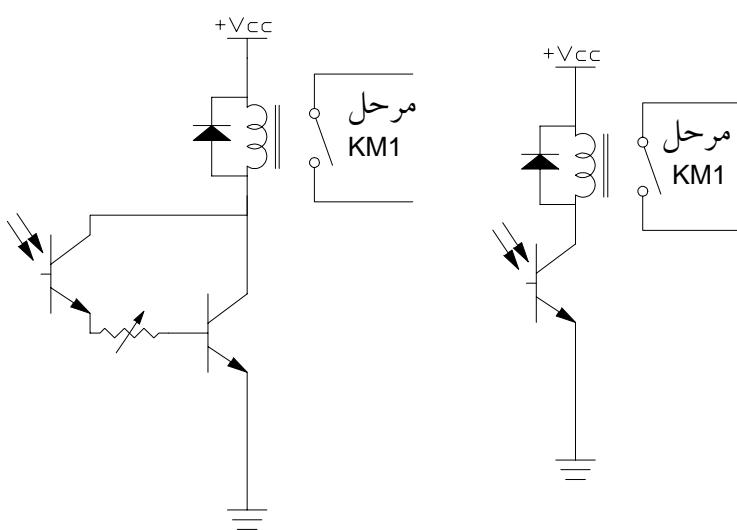
الإشارة في هذا النوع من المجرسات يوضع المشع والمستقبل على نفس المستوى من السطح كما في الشكل (2) ، حيث يستشعر بوجود الجسم عند انعكاس الشعاع من الجسم ، ويتم استقباله عن طريق المستقبل ، أما في حالة عدم وجود جسم فإن المستقبل لا يستقبل إشارة .

تستخدم الملقطات الضوئية بأنواعها بكثرة في الآلات المكتبية لاستشعار وجود الورق ومكان تعثره في آلات التصوير والطابعات .

شكل (2)



مبدأ العمل : التحكم في تشغيل مرحل.



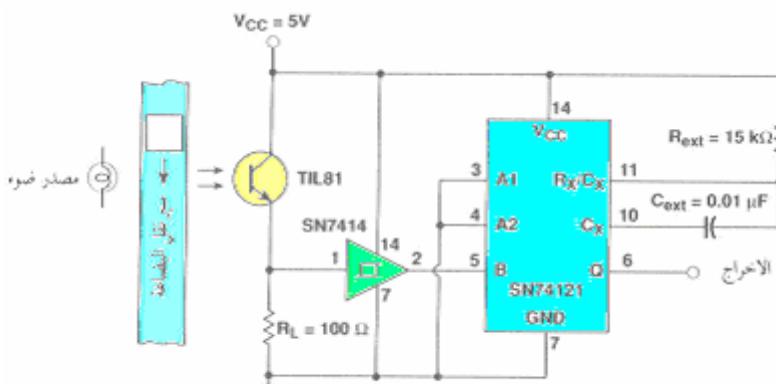
شكل(1)

الدارة في الشكل (1) تعمل على التحكم في تشغيل المرحل بواسطة الضوء عندما يكون الترانزستور في الظلام أو مستوى إضاءة منخفض يكون الترانزستور في حالة القطع، مما يعني أن ملامسات المرحل مفتوحة و عند ارتفاع شدة الإضاءة تعمل على نقل الترانزستور إلى التشبع ويمر تيار في ملف المرحل فيعمل ويغلق الملامسات و بهذا يعمل الحمل الكهربائي .

ممكן استخدام ترانزستور ضوئي ذو طرفين فقط و وصله مع ترانزستور آخر توصيلية دارلوجتون (إذا لم يكن تيار الترانزستور الضوئي كاف لتشغيل المرحل أو استخدام ترانزستور ذو ثلاثة أطراف لضبط حساسية الإضاءة .

مثال :

عند سقوط الضوء على وصلة المجمع - القاعدة الموصلة في انحياز عكسي سيتولد زوج من الإلكترونات والفحوات بسبب الطاقة الضوئية الساقطة ويزداد تيار المجمع بزيادة شدة الإضاءة والترانزستور الضوئي يكون أكثر حساسية للضوء لوجود خاصية التكبير في الترانزستور .



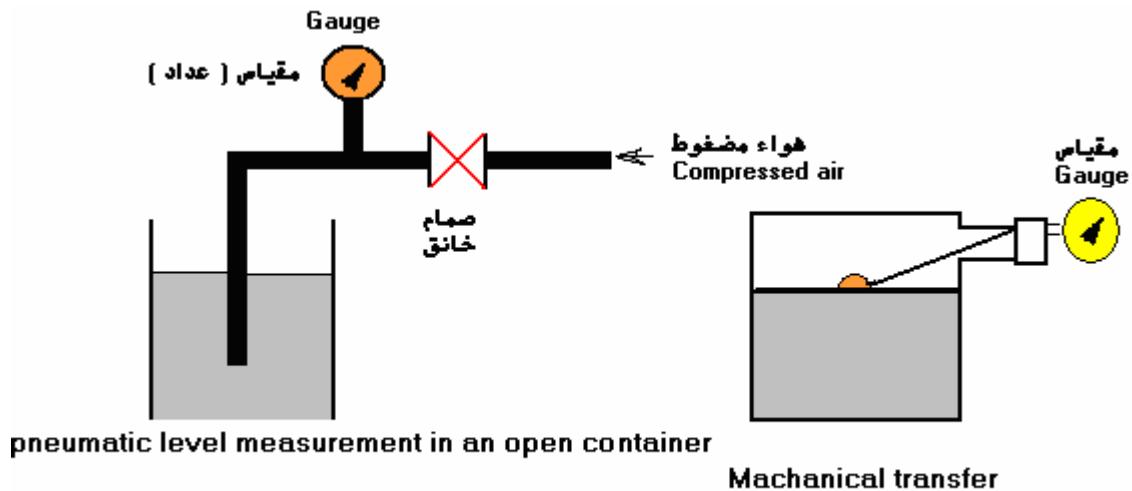
إن الشكل يبين استعمالاً آخر لمصدر ضوء كالدiod الضوئي والترانزستور الضوئي للكشف وجود أو غياب القطع على سير نقل البضاعة في المصنع . وهذا هو المخطط البياني الكامل . ومجدداً ، فإن الضوء الذي يبلغ الترانزستور الضوئي (لا يوجد إنتاج في الوضعيّة) يجعل الترانزستور الضوئي يقوم بالايصال ، بحيث يولد حوالي 5V تقرن مع الجهاز SN7414 . وعندما يمنع (يصد) الضوء إلى الترانزستور الضوئي بواسطة الإنتاج على السير ، فإن الترانزستور يتوقف بحيث تكون الفولتية على الجهاز SN7414 معدومة (صفر) .

أما الجهاز SN7414 فإنه يكشف هذا التأرجح في الفولتية من 5V إلى صفر فولت ، ثم يرسل نبضة إلى SN7414 الذي يولد نبضة من فترة زمنية ثابتة تبلغ 100 ميكروثانية. وهكذا ،

الملقطات المستوى

يوجد طرق عديدة لقياس أو مراقبة المستوى الممتليء مثل :

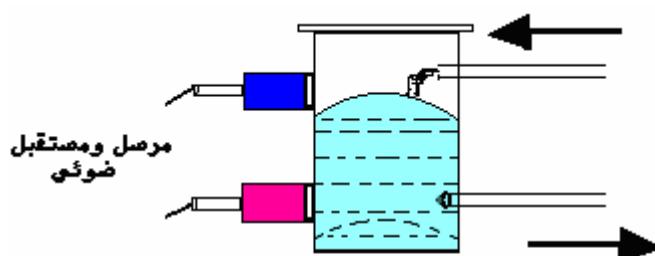
قياس المستوى بتغير المقاومة . والشكل يوضح هذه الطريقة حيث تستخدم عوامة ميكانيكية موصولة بذراع مقاومة متغيرة والمقاومة الموصولة بمقاييس يعطي مثل معايرته ليعطي ارتفاع السائل مباشرة .



قياس المستوى بواسطة الهواء المضغوط والشكل يوضح هذه الطريقة . وفي هذه الطريقة يتم تعطيسن (غمس) أنبوبة المراد قياسة ويدفع خلال هذه الأنبوة ماء مضغوط أو غاز حامل خلال صمام خانق صغير throttle ، والضغط الراجع (المرتد) من سريان تدفق الهواء وراء الصمام ويعتمد على مستوى السائل في الخزان حيث مستوى السائل الأعلى يقابله ضغط أعلى ويمكن قياس مستوى السائل بواسطة مقياس أو عداد يتم معايرة تدريجة بوحدات الارتفاع . وهذه الطريقة عملياً مناسبة للسوائل عالية التلوث ، وذات الزوجة ، والسوائل المتبلورة .

مراقبة المستوى بواسطة الحساسات الضوئية :

الشكل يوضح طريقة أخرى لمراقبة المستوى بواسطة استخدام الحساسات الضوئية حيث يستخدم حساسين مثلاً لمراقبة المستوى المطلوب .



Filling - level monitoring

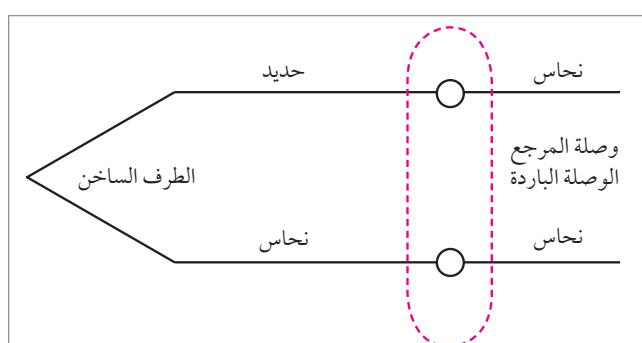
الملقطات الحرارية

1 - الكواشف الحرارية (TDR)

هو أداة (محس) لقياس درجة الحرارة ، وهو من أقدم أنواع المحسات ، ويعتمد مبدأ عمله على تغير مقاومة المعادن مع درجات الحرارة ، ويتم اختيار معادن ذات معامل حراري كبير (زيادة الحساسية) وتكون ذات معامل حراري موجب - أي تزيد المقاومة بزيادة درجات الحرارة -

تعريف الأزدواج الحراري: Thermocouple:

هو من أبسط أنواع المحسات المستخدمة في قياس درجات الحرارة وأكثرها انتشاراً وخاصة في درجات الحرارة المرتفعة . ويتكون من سلكين من نوعين مختلفين من السبائك (المعادن) موصولين في نهاية واحدة . عند ارتفاع درجة الحرارة يتولد فرق جهد قليل بين طرفي الأسلاك . ويتناصف فرق الجهد مع فرق درجات الحرارة ويعتمد أيضاً على المادة المصنوع منها .

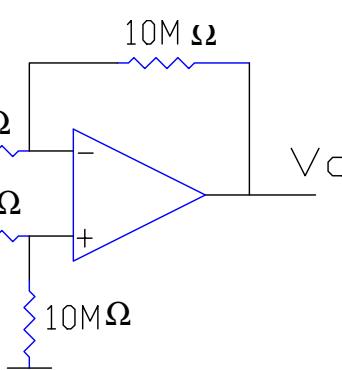


التركيب:

يتكون من وصلتين وصلة القياس (الجس ، الحرارة ، الساخن +) والوصلة المرجعية (الباردة ، السالبة -) لاحظ الشكل (1) ويتوفّر منه عدّة أنواع بناءً على مادة السبائك المصنوع منها ، ومنها مشهور مثل (R , S , E , J , K) وهناك أنواع أخرى مثل (C , G , B)

مثال :

تحويل درجة الحرارة إلى جهد كهربائي :
من الناحية النظرية عند استخدام ازدواج حراري من نوع K مثلاً نلاحظ أنه يعطي 38.3 ميكرو فولت لكل درجة حرارة ، في هذا المثال نفرض أن درجة الحرارة تغيرت من 0 - 100 درجة مئوية (على فرض أن



العلاقة خطية على الفترة المختارة وفرق الجهد على درجة حرارة الصفر يساوي صفرأً .

يكون فرق الجهد الناتج : $V = 100 \times 38.8 \mu V = 0.388 mV$

إذن نحتاج إلى دارة مضخم لتكيّير الإشارة الناتجة من الأزدواج الحراري ، ونختار مضخماً ذا معامل تكبير عالٍ ول يكن 10^4 فيكون التغيير في الجهد من 0 - 3.38 .

دارة المضخم التي تم اختيارها في هذا المثال مضخم العمليات الطارح مع معلم تكبير 10^4 لاحظ الشكل

$$\text{حيث تكون } R_t / R_{in} = 100\Omega \text{ إذا كانت } R_{in} = 1M\Omega .$$

ممكن استخدام فرق الجهد الناتج من الدارة في عمل دارة ميزان حراري إلكتروني أو ممكن استخدامه في التحكم بالعمليات الصناعية .

2 - **الثيرمستور Thermistor**

هو مقاومة ذات حساسية عالية للتغيرات درجة الحرارة ، وتصل دقتها إلى $(0.2 - 0.1)$ أوم لكل درجة حرارة مئوية ، ويصنع من مواد شبه موصلة وبعض أكسيد المعادن مثل الحديد والنيكل والكروم .
ويصنف الثيرمستور إلى مجموعتين : الأولى ذات معامل حراري سالب NTC أي أن مقاومته تنخفض بازدياد درجة الحرارة . والثانية ذات معامل حراري موجب PTC أي أن مقاومته تزداد بازدياد درجة الحرارة ، ويدخل في صناعتها البلاتين ، وحساسيتها أقل من حساسية NTC .

أشكاله:

تم صناعة الثيرمستور كما هو مبين في الشكل (1) بعدة أشكال لتناسب تطبيقاته المختلفة ، وتغطي بطبقية من السيراميك أو الزجاج ، ومن هذه الأشكال :

- الأسطواني .
- القرصي .
- الحلقي .
- الخرزي .



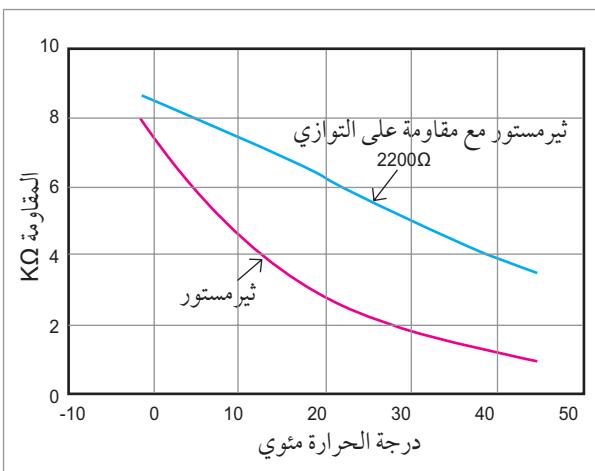
شكل (1)

منحنى خصائص الثيرمستور:

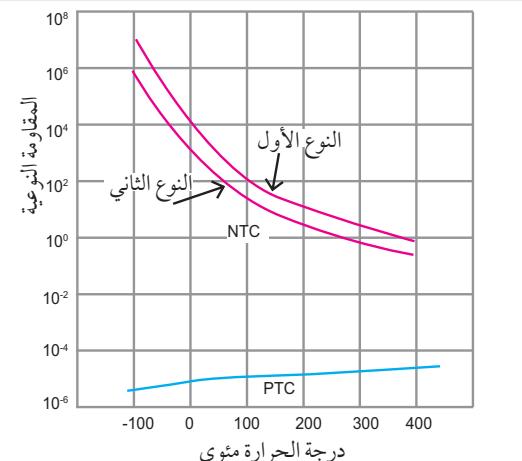
يوضح الشكل (1) العلاقة بين المقاومة النوعية للثيرمستور والتغيير في درجة الحرارة .

يلاحظ من المنحنى أن الثيرمستور NTC مقاومته تقل بارتفاع درجات الحرارة ، والثيرمستور PTC مقاومته تزداد بارتفاع درجات الحرارة ، والعلاقة غير خطية .

وللتخلص من العلاقة غير الخطية وجعلها تقريباً خطية يوصل الثيرمستور NTC بالتوازي مع مقاومة كربونية فينتج منحنى كما في الشكل (2) علاقة خطية



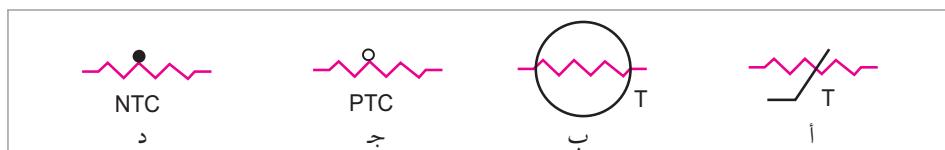
شكل (2)



شكل (1)

رموز:

يبين الشكل رمز الشيرمستور NTC ، PTC ،



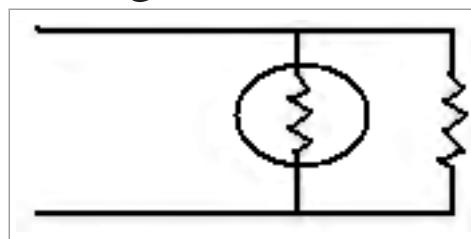
ميزاته:

- زمن الاستجابة صغير نسبياً .
- الدقة العالية .
- حجم صغير .
- تكلفة قليلة
- له عدة أشكال .
- اسقراطية عالية .

ويتوفر منه عدة أنواع حسب مادة التصنيع والشكل مثل سلسلة PT ، KT التي تعمل على مدي حراري (120-180 °C) و KS ، PS التي تعمل على المدى (-80 - +75 °C) . من الملاحظ أن مدي درجات الحرارة التي للثيرمستور أقل من الأزدواج الحراري والكواشف الحرارية .

درات التعويض .

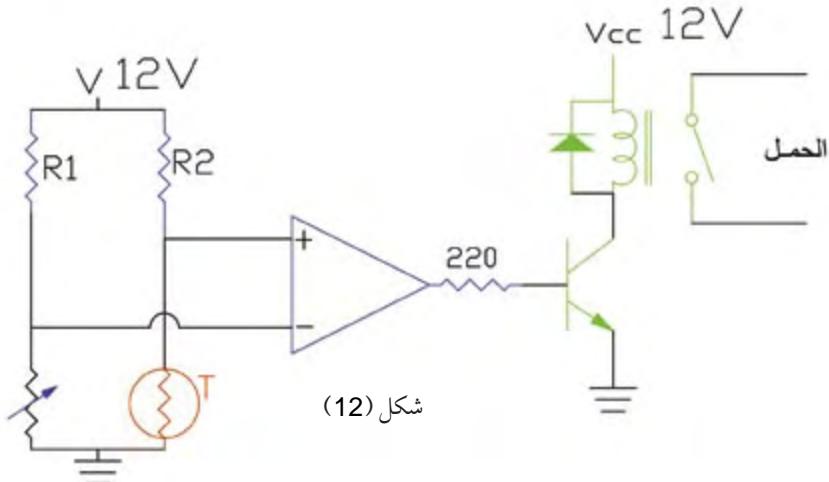
تتأثر بعض الأجهزة الإلكترونية بدرجة الحرارة فتزيد قيمة مقاومتها مما يؤدي إلى خلل في عملها . و لعلاج هذه المشكلة توصل مقاومة ثيرمستور NTC بالتوالي مع مقاومة كربونية



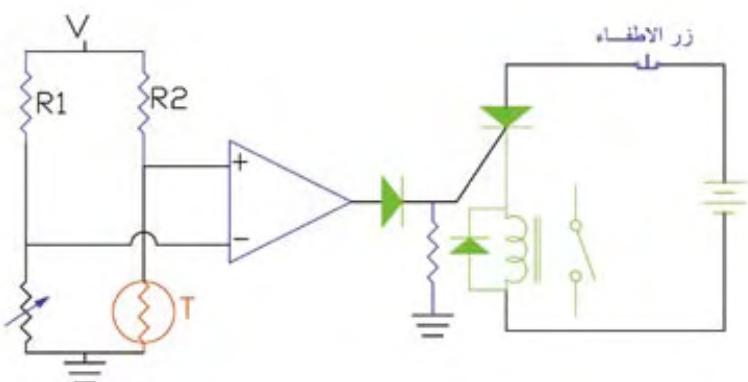
عند ارتفاع درجة الحرارة ترتفع مقاومة الحمل ولكن مقاومة الثيرمستور تنخفض وبما أنهما على التوالي تكون قيمة المقاومة الكلية ثابتة تقريباً أي يعمل الثيرمستور على إلغاء تأثير الحرارة في المقاومة الكلية للدارة أو التقليل منها .

تشغيل الأحمال مثل محرك (مروحة).

باستخدام قنطرة ويستون كما في الشكل (12). في الوضع الطبيعي (أي أقل من درجة الحرارة المطلوبة) يكون الجهد على المخرج (مخرج مكبر العمليات) صفرًا، أو يكون في حالة تشبع سالب، وهذا لا يؤدي إلى تشغيل الترانزستور ولا يعمل المرحل.



عندما تتغير درجة الحرارة للوسط الموجودة فيه الشيرمستور PTC تغير مقاومته (ترتفع) مما يؤدي إلى رفع الجهد وعدم اتزان القنطرة، وعند نقطة معينة تعين بواسطة المقاومة المتغيرة أي وصول درجة الحرارة المطلوبة يكون الجهد على القنطرة كافياً إلى نقل المقارن إلى التشبع الموجب، ويتم أيضاً تشغيل الترانزستور الذي يعمل على إغلاق تلامسات المرحل ويعمل الحمل.



إنذار حريق.

عند وقوع حريق في مكان ما ترتفع درجة الحرارة وتؤثر على المحسس الحراري (وهو في هذا المثال الشيرمستور) وهذه بدورها تعمل على نقل مكبر العمليات إلى التشبع الموجب الذي يعمل على نقل الثنائي إلى حالة التوصيل وتشغيل المرحل الذي يعمل على تشغيل جرس الإنذار لاحظ الدارة في الشكل

المقاومة المتغيرة تعمل على ضبط درجة الحرارة التي يراد تشغيل الإنذار عنها. ويوضع الثنائي لمنع التيار السالب عند انخفاض درجة الحرارة بشكل يؤدي إلى جعل المقارن يعمل في حالة تشبع السالب. تغذية الدارة للشيرمستور DC وذلك لجعلها في حالة التوصيل إلى أن يتم الضغط على مفتاح الإطفاء.

التدريس بالمشاريع

الإنجاز: الوضعية الإيجابية

دارة تحكم في سرعة محرك
التحكم في المحرك الاتزامني

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية ولاية الأغواط
ثانوية الحى الجنوبي بلدية آفلو
الأستاذ المهندس : لواصف بوفاتج



المقاومة الضوئية LDR

دارة تحكم في سرعة محرك الوضعية الإماجية

الوحدة

لواسف
بوفاتح

الأجهزة والأدوات:

الجهاز	مصدر ضوئي	مصدر تغذية	جهاز DMM	لكلمة 1	المواصفات
مصدر تغذية	مصدر ضوئي	جهاز DMM	جهاز	1	12V
جهاز	مصدر ضوئي	مصدر تغذية	مصدر تغذية	1	12V
مصدر ضوئي	مصدر ضوئي	مصدر ضوئي	مصدر ضوئي	1	مصباح 12V أو مصباح 220V

المواد المستخدمة:

العنصر	LDR مقاومة ضوئية	محرك	ترانزستور	لكلمة 1	المواصفات
محرك	LDR مقاومة ضوئية	ترانزستور	ترانزستور	1	BD 137
مقاومة متغيرة	مقاومة متغيرة	motor	motor	1	DC 12 V
مقاومة	مقاومة	motor	motor	2	10KΩ
مقاومة	مقاومة	motor	motor	1	220Ω

المعلومات الأساسية:

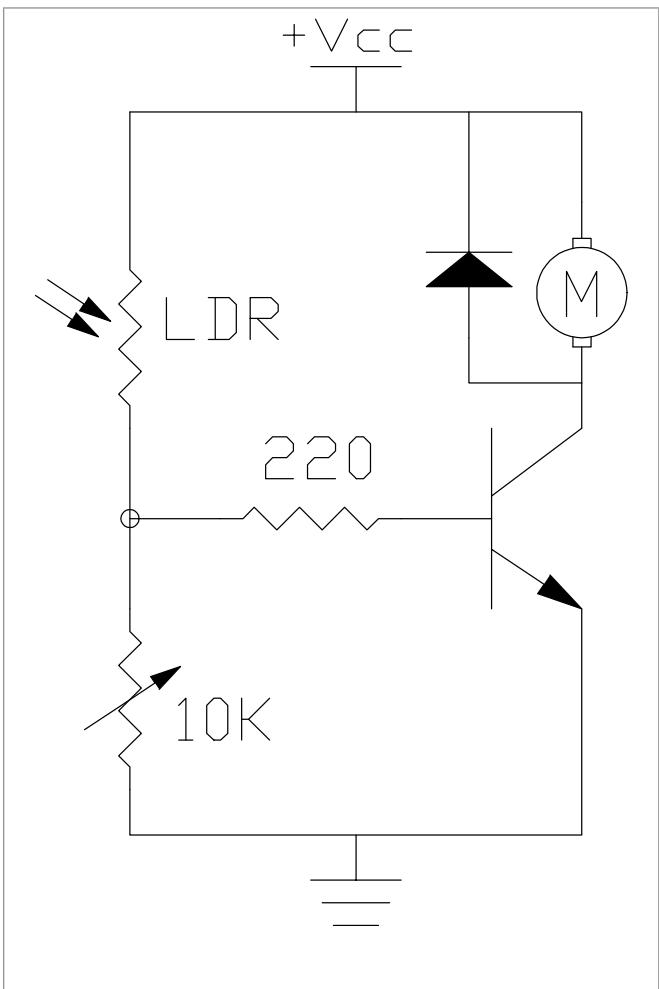
المقاومة الضوئية هي مقاومة تتغير قيمتها تبعاً لغيرات كثافة الضوء الساقط على سطحها، وتناسب قيمتها تناوباً عكسياً مع شدة الإضاءة حيث تتناقص قيمتها عند تعرضها للضوء، و تكون في الظلام مقاومتها عالية جداً.

المقاومة الضوئية تعامل كالمقاومة العادية من حيث ظروف التشغيل الواجب مراعاتها خصوصاً القدرة

و كذلك من حيث الأعطال، ومن سماتها أنها بطيئة الاستجابة.

تستعمل المقاومات الضوئية في كثير من التطبيقات التي تشترك جميعها في الإحساس بالضوء ومن هذه التطبيقات أنظمة التحكم المعتمدة على وجود الضوء أو عدمه مثل : التحكم في إضاءة الشوارع ليلاً ، التحكم الآلي وأجهزة الإنذار (مثل الإنذار بوجود حريق إنذار ضد السرقة) .

كما هو مبين في الشكل (1) يعتبر الضوء العامل الأساسي في الدارة حيث تتناسب قيمة المقاومة LDR مع شدة الضوء الساقط عليها تناسباً عكسيّاً و تحدد المقاومة قيمة تيار القاعدة للترانزستور ، أي أن قيمة تيار القاعدة في هذه الدارة تتناسب طردياً مع شدة الإضاءة . الحمل في الدارة موصول على المجمع أي يمر به تيار I_C فعندما لا يكون هناك ضوء فلا يمر تيار في قاعدة الترانزستور ولا يعمل المOTOR أي يكون فرق الجهد على المOTOR يساوي صفر . وعند توفر إضاءة ضعيفة تنخفض قيمة المقاومة الضوئية بشكل يتناسب مع شدة الإضاءة فيمر تيار في قاعدة الترانزستور فيتقل الترانزستور من القطع إلى التوصيل ، وينخفض جهد V_{CE} ويرتفع الجهد على المOTOR ويتنااسب فرق الجهد على الحمل تناسباً طردياً مع شدة الإضاءة ، فكلما زادت شدة الإضاءة زادت سرعة دوران المOTOR . أي أن سرعة دوران المOTOR تتناسب طردياً مع شدة الإضاءة .



شكل(1)

خطوات العمل:

أ- فحص المقاومة الضوئية وأثر الضوء عليها :

- . أحضر المقاومة الضوئية و جهاز الأوميتر .
- . افحص قيمة المقاومة وسجل قيمتها في الجدول (1) في الحالات التالية :
 - أ. في الظلام .
 - ب. في ضوء الغرفة .
 - ج. شغل مصدر ضوئي و اجعل المقاومة الضوئية بعيدة عنه تقريراً 1 م ثم قس قيمتها .
 - د. قرب المقاومة الضوئية من المصدر الضوئي (تقريراً نصف المسافة) ثم قس قيمتها .
 - هـ. قرب المقاومة الضوئية من المصدر الضوئي أكثر ثم قس قيمتها .

الحالة	الظلام	ضوء الغرفة (ضوء ضعيف)	بعيدة عن المصدر الضوئي 1 م	نصف المسافة إضاءة متوسطة	قريبة جداً إضاءة قوية جداً
قيمة المقاومة					

جدول (1)

■ بـ التحكم في سرعة محرك عن طريق الضوء .

. ركب الدارة التي في الشكل (1) .

. اضبط مصدر التغذية على 12V (يعتمد على المحرك المتوفر) .

. شغل الدارة على ضوء الغرفة ثم اضبط المقاومة المتغيرة بحيث لا يدور المحرك .

. إملاء الجدول (2) :

موقع المقاومة الضوئية	بعيدة عن المصدر الضوئي (إضاءة ضعيفة)	نصف المسافة إضاءة متوسطة	قريبة جداً إضاءة قوية جداً
سرعة المحرك			
الجهد على المحرك			
VCE			

جدول(2)

التقويم:

- ما أثر الضوء على المقاومة الضوئية .
- ما علاقة سرعة المحرك مع الضوء .
- كيف يمكن عكس عمل الدارة التي في الشكل (1) . (حيث تتناقص سرعة المحرك مع زيادة الضوء) .

الوحدة

الترازستور الضوئي التحكم فى المحرك الاتزامنى الوضعية الإماجية

لواسف
بوفاتح

الأجهزة والأدوات:

المواصفات	الكمية	الجهاز
	1	DMM
0 - 15 V	1	مصدر تغذية

المواد المستخدمة :

المواصفات	لكمية	العنصر
	1	ترازستور ضوئي
12 V	1	مرحل
12- 24 V 220V 2A	1	Soled States Relay
BD137	1	ترازستور
1N4001	1	ثنائي
LM741	1	مكابر عمليات
10KΩ	1	مقاومة متغيرة
470 Ω X2 1KΩ 10KΩ X2 33KΩ	6	مقاومة كربونية
12V	1	مصباح كهربائي

المعلومات الأساسية :

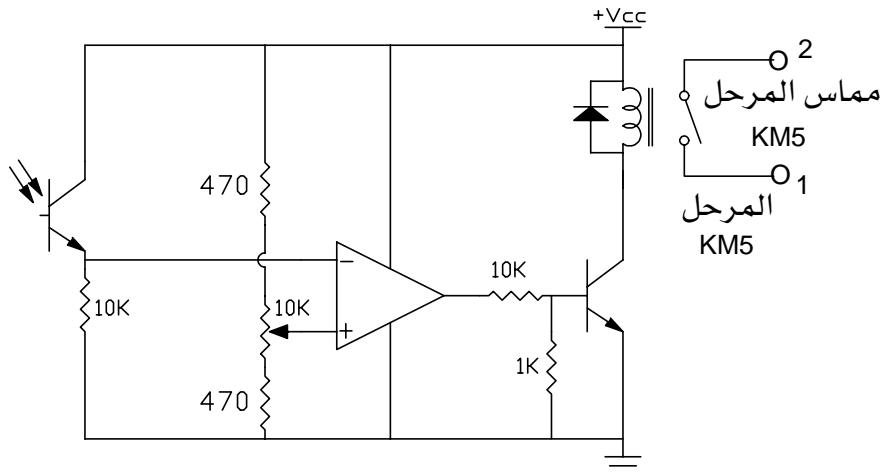
يشبه عمل الترازستور الضوئي عمل الترازستور العادي إلا أنه يعتمد على الظاهرة الفولتية الضوئية (Photovoltaic Effect) حيث أن قاعدة الترازستور حساسة للضوء . يتولد تيار القاعدة بالضوء ويتناوب مع شدة الإضاءة على السطح الحساس للضوء . ومن ميزاته أنه سريع الاستجابة .

عند وضع الترازستور الضوئي في الظلام يصبح في حالة قطع ولا يمر تيار بين المجمع و الباعث و عند تعرض السطح الحساس للضوء يتولد تيار قاعدة صغير ينبع عن ذلك تيار كبير يمر بين المجمع و الباعث . كما توجد أيضاً ترازستورات تأثير المجال الضوئي التي تستخدم التأثير الضوئي في توليد جهد البوابة الذي يتحكم بتيار المصرف (Drain) - المنبع (Source) .

هناك عدة أنواع من الترانزستورات الضوئية منها ذات الطرفين وهي حساسة للضوء ولكن عند توفر إضاءة ضعيفة تكون غير قادرة على توليد تيار في القاعدة كافي للانتقال إلى التشبع (تيار مناسب). وهناك ترانزستورات ذات ثلاثة أطراف بالإضافة طرف القاعدة الذي يستخدم لتشييد انجاز الترانزستور بحيث يمكن من التحكم في حساسيته للضوء بشكل جيد. وترانزستورات دارلنجلتون الضوئية وهي تميزة بحساسيتها العالية للضوء وبنها الاستجابة كبيرة نسبياً، وتتوفر هذه الترانزستورات برقائق قاعدة أو بدونها.

للترانزستورات الضوئية كما للترانزستورات العادية جهد انهايار و معدلات جهد و تيار تشغيل و منحنى خصائص .

التحكم في تشغيل مرحل باستخدام ترانزستور ضوئي و تشغيل حمل كهربائي .



- صل الدارة كما في الشكل وأنجز دارتى التحكم والإستطاعة للمحرك

- صل مختلف الدارات مع بعضها البعض

- اضبط جهد التغذية على 12V .

- شغل الدارة ولاحظ تأثير الضوء على عمل الدارة .

- حدد شدة الإضاءة التي يعمل عليها المرحل بمساعدة المقاومة المتغيرة P1 10KΩ حتى إقلاع المحرك

التقويم :

- ما وضفة المرحل السكونى وملقط الضوء فى إقلاع المحرك

- ما أثر الضوء على الترانزستور و إقلاع المحرك

- ما سبب استخدام الترانزستور BD137 في الدارة .

- ما وظيفة الثنائي في الدارة .

- أذكر تطبيقات عملية ممكن استخدام الترانزستور الضوئي فيها .

AUTEUR : **فؤاد - جعفر**

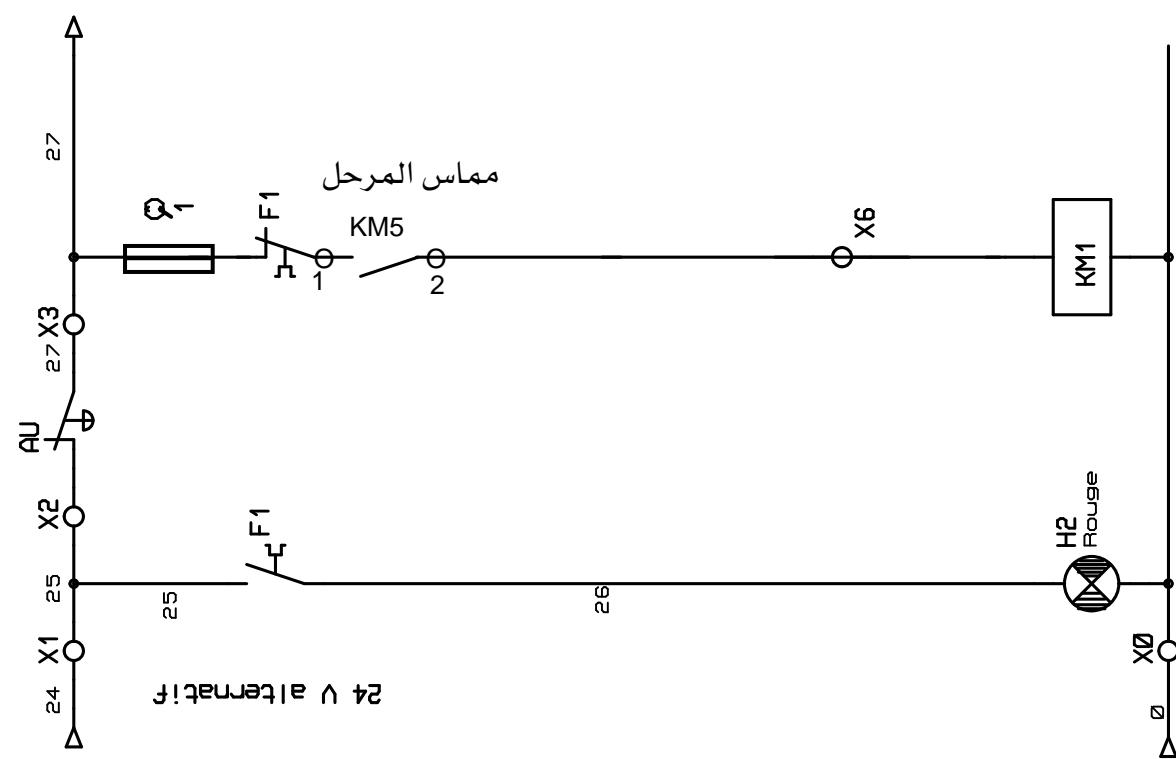
DATE :

REV:

CLIENT :

TITRE :

PROJET :

LOUASSEF BOUFAETH**ماس المراحل**

الوحدة

الثيرمستور (ctn)(ctp)

التحكم في المحرك الاتزامنى الوضعية الإلماجية

لواسف
بوفاتح

الأجهزة والأدوات:

الجهاز	مصدر حرارة	غایة ماء (أو أي مصدر)	مصدر تغذية	جهاز DMM	الكمية 1	المواصفات
جهاز DMM					1	
مصدر تغذية					1	12V
مصدر حرارة					1	غاية ماء (أو أي مصدر)

المعلومات الأساسية :

الثيرمستور هي مقاومة ذات حساسية عالية لغيرات درجة الحرارة (مجس حراري)، وتصنع من مواد شبه موصلة وبعض أكسيد المعادن مثل الحديد والنحاس والكروم ، وتصنف الثيرمستور إلى مجموعتين الأولى ذات معامل حراري سالب NTC أي أن مقاومتها تنخفض بازدياد درجة الحرارة . و الثانية ذات معامل حراري موجب PTC أي أن مقاومتها تزداد بازدياد درجة الحرارة ، ويدخل في صناعتها البلاتين وهي أقل حساسية من NTC في هذا التمرين سيتم استخدام الثيرمستور لتشغيل الأحمال ، تركب الثيرمستور في قنطرة ويستون كما في

إذا كانت درجة الحرارة أقل من الدرجة المطلوبة (التي يتم تحديدها بواسطة المقاومة المترتبة) يكون الجهد على المخرج (مخرج مكبر العمليات) سالب أي يكون المقارن في حالة تشبع سالب وهذا لا يؤدي إلى تشغيل الترانزستور ولا يعمل المرحل . عندما تتغير درجة الحرارة للوسط الموجودة فيه الثيرمستور PTC تتغير مقاومتها (ترتفع PTC) مما يؤدي إلى رفع الجهد و عند ارتفاعها عن النقطة المعينة أي وصول درجة الحرارة المطلوبة يتحول المقارن إلى التشبع الموجب و يتم أيضاً تشغيل الترانزستور الذي يعمل على إغلاق تلامسات المرحل ويعمل الحمل .

خطوات العمل :

- صل الدارة كمافي الشكل وأنجز دارتى التحكم والإستطاعة للمحرك

- صل مختلف الدارات مع بعضها البعض

- أحضر ثيرمستور من نوع PTC .

- ضع الثيرمستور في كأس ماء ثم ركب على طرفي الثيرمستور أو مميت.

- اضبط جهد التغذية على 12V .

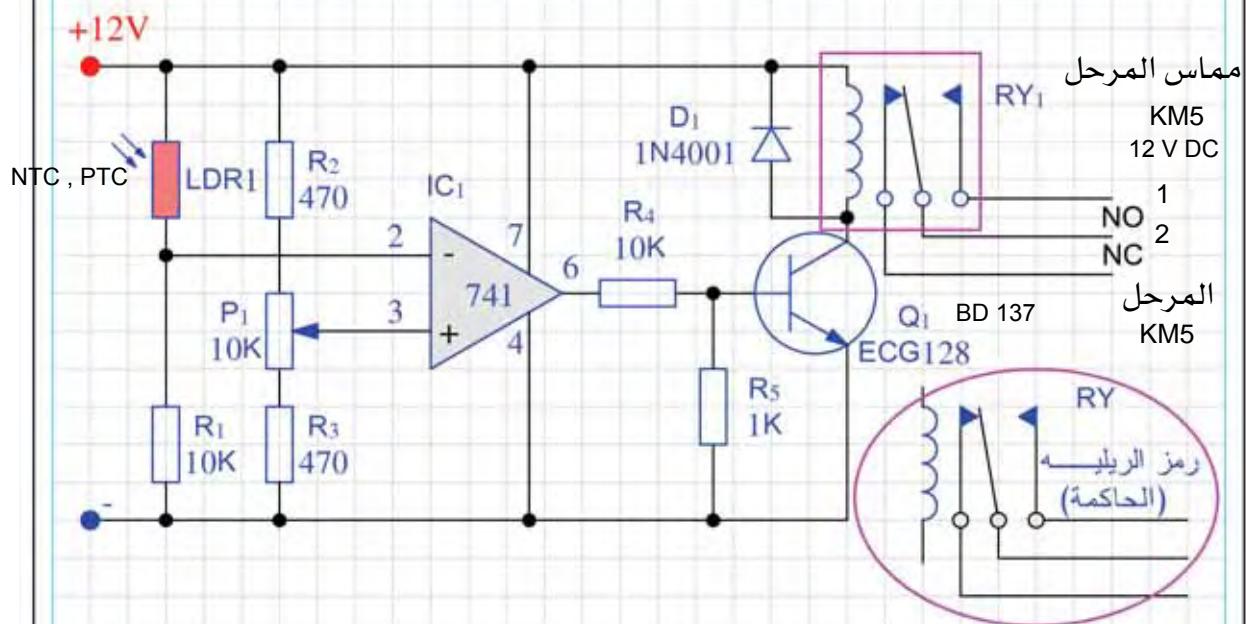
- شغل الدارة وأضبط قيمة المقاومة حتى إقلاع المحرك

تمرين

2-50

الشكل يبيّن دارة لاحدي تطبيقات مكبر العمليات 741 ، يطلب إعادة الرسم بمقاييس رسم 1:1 . لاحظ الحاكمة وتماساتها في حالتي التوصيل :

Normally Open (NO) , Normally Closed (NC)



: التقويم

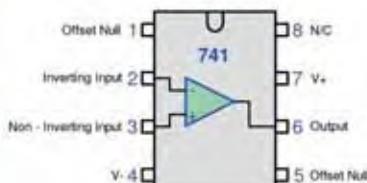
- ما وظيفة المراحل السكوني وملقط الحرارة في إقلاع المحرك
- ما أثر الحرارة على إقلاع المحرك
- ماسبب استخدام الشيرمستور في الدارة .
- اذكر تطبيقات عملية ممكن استخدام الشيرمستور فيها .

رقم اللوحة 2-75	المدرسة	اسم الطالب	تطبيقات مكبر العمليات 741
مقاييس الرسم	التاريخ	الجدول	أداة تعمل عند الأضاءة / التعزيز

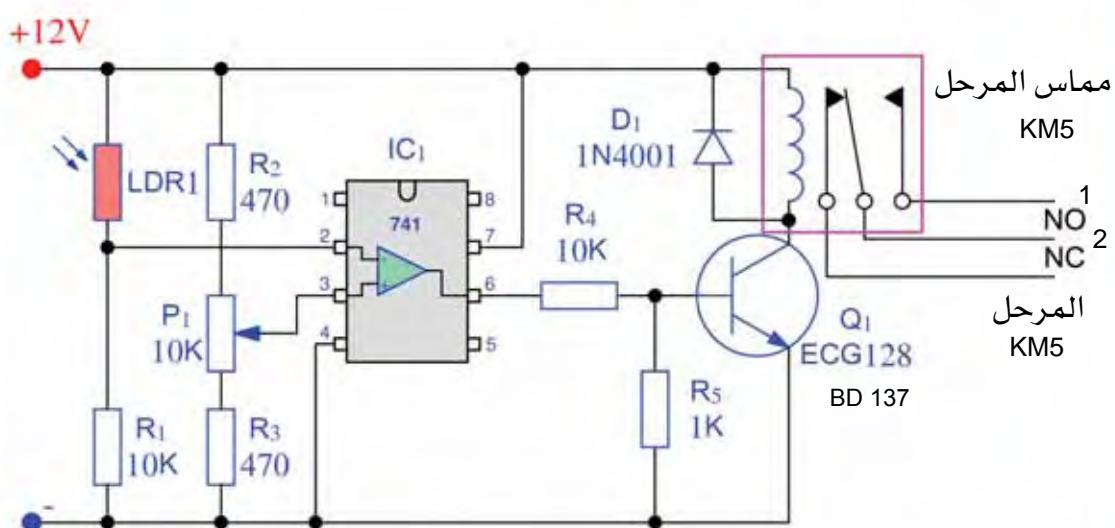
مثال

2-8

الشكل يبيّن شكل الدارة المتكاملة 741 ذات الثمانية أطراط ، لاحظ طريقة ترقيم الأطراط عكس عقارب الساعة ابتداء من البروز أو العلامة المميزة للطرف 1. أرسم الدارة من جديد باستبدال رمز الدارة 741 بشكل الدارة الفعلية. وبالاعتماد على الجدول الذي يبيّن توزيع أطراطها.



توزيع أطراط الدارة المتكاملة 741	
1	تغير أوفست
2	المدخل العاكس
3	المدخل غير العاكس
4	سائل التغذية (الأرضي)
5	تغير أوفست
6	المرج
7	موجب التغذية
8	بدون توصيل



يعتمد مبدأ الدارة يعتمد على أن الحاكمة (الريليه) تغير من وضعيتها عند سقوط الضوء على المقاومة الضوئية حيث أن ذلك يسبب انخفاض قيمتها مسبباً بغير جهد الخرج في مكبر العمليات وبالتالي يعمل الترانزستور كمفتوح مشغلاً الحاكمة. لقلب عمل الدارة يتم استبدال المقاومة الضوئية بالمقاومة R_1 . يستخدم الثنائي لمدفع حدوث شرارة عند فتح الحاكمة. تستخدم المقاومة المتغيرة لضبط وتغيير حساسية الدارة.

رقم اللوحة 2-76	المدرسة	اسم الطالب	تطبيقات مكبر العمليات 741
مقاييس الرسم	التاريخ	الجدول	أداة تعمل عند الاضاءة / التعزيز

AUTEUR : **فؤاد - جعفر**

DATE :

REV:

TITRE :

CLIENT :

PROJET :

LOUASSEF BOUFAETH**جعفر بو فايث****جعفر بو فايث**